# U.N.A.M.

# FACULTAD DE CIENCIAS



# "ESTRUCTURA DE LA FRONTERA DE GRANO EN COBRE USANDO MICROSCOPIA ELECTRONICA"

Que para obtener el Título de F I S I C O P r e s e n t a JOSE REYES GASGA

México, D. F. Noviembre 1983



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

# DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## INDICE

Página

INTRODUCCION	
CAPITULO I LA ESTRUCTURA DE LA FRONTERA DE GRANO	3
1.1 - EL MODELO DE LA ESTRUCTURA AMORFA	3
1.2 - EL MODELO DE ISLAS	4
1.3 - EL MODELO DE DISLOCACIONES	4
1.4 - EL MODELO DE SITIOS DE COINCIDENCIA	8
1.5 - EL MODELO DE LA "O-LATTICE"	12
1.6 - EL MODELO DE LA UNIDAD ESTRUCTURAL	15
1.7 - PROPIEDADES DE LA FRONTERA DE GRANO	17
1.7.1 Migración de la Frontera de Grano	18
1.7.2 Segregación de la Frontera de Grano	19
1.7.3 Deslizamiento de la Frontera de Grano	20
CAPITULO II MICROSCOPIA ELECTRONICA	25
2.1 - GENERALIDADES	25
2.2 - FENOMENOS ASOCIADOS A LA INTERACCION ELECTRON-SOLIDO	26
2.2.1 Formación de Imágen en el SEM	29
2.2.2 Formación de Imágen en el TEM	30
2.2.3 Aberraciones	32
2.3 - DIFRACCION DE ELECTRONES	34
2.3.1 Ley de Bragg, Ecuaciones de Laue y la Amplitud de Dispersión	35
2.3.2 Esfera de Ewald	40
2.3.3 Desviación de la Condición de Bragg	41
2.3.4 Formación de un Patrón de Difracción	43
에는 가장 가장 관계가 가지 않는다. 또한 것은	

# Página

	, aga
2.4 - CONTRASTE EN EL MICROSCOPIO ELECTRONICO	44
2.4.1 La Teoría Cinemática	45
2.4.2 La Teoría Dinámica	49
2.4.3 Absorción	52
2.4.4 Efecto de Inclinación de la Muestra	54
CAPITULO III PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL	56
3.1 - PREPARACION DE MUESTRAS	56
3.2 - OBSERVACION CON EL MICROSCOPIO	62
3.2.1 Calibración del Microscopio	62
3.2.2 El Contraste en el Microscopio	63
3.2.3 Determinación de la Orientación	65
3.2.3a Indización de los Patrones de Difracción	65
3.2.3b Cálculo de las Parejas Angulo/(Eje de Rotación)	68
CAPITULO IV RESULTADOS, DISCUSION Y CONCLUSION	72
4.1 - RESULTADOS	72
4.2 - DISCUSION	99
4.3 - CONCLUSION	110
그는 것 같은 것은 것 같은 것은 것은 것은 것을 하는 것 같은 것 같	

# APENDICE

112

115

BIBLIOGRAFIA

#### INTRODUCCION

Tres mecanismos son los responsables de los fenómenos que ocurren en nuestras policristalinas durante el proceso de termofluencia: la generación y movimiento de dislocaciones cristalinas, la difusión de átomos en el interior de los granos y en las fronteras de grano, y el deslizamiento y migración de la frontera.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la influencia de la frontera de grano en el mecanismo de deformación a alta temperatura y relacionar la información obtenida con la estructura de la frontera.

Para este efecto se observaron en el Microscopio Electrónico de Transmisión muestras de cobre previamente sometidas a un tratamiento de termofluencia.

Los resultados obtenidos fueron consistentes con la hipótesis de que la migración y deslizamiento de la frontera de grano es producido por el movimiento de dislocaciones en la frontera. A partir de ésto, se clasificó a las fronteras en:

- a) FRONTERAS DE COINCIDENCIA, presentan dislocaciones y pequeñas protuberancias, indicando zonas de migración localizada.
- b) FRONTERAS DE NO COINCIDENCIA, que a su vez se dividen en:
  - i) Fronteras que tienen estructura, presentando dislocaciones en ella. Al migrar forma zonas de excesi-

va difusión de vacancias las cuales coalecen produciendo hoyos cercanos a la frontera.

 ii) Fronteras sin estructura, que durante el proceso de termofluencia no parecen tener la periodicidad requerida para sostener dislocaciones.

Además se propone un nuevo mecanismo capa de explicar la formación de cavidades durante el proceso de termofluencia.

El material se presenta en cuatro capítulos. En el primero se hace una breve descripción de las teorías existentes sobre la estructura de la frontera de grano. En el capítulo II se describen los aspectos esenciales del microscopio electrónico y los mecanismos de contraste. En el capítulo III se detalla el proceso experimental y en el capítulo IV se describen y discuten los resultados obtenidos, con su conclusión final.

## CAPITULO I

#### LA ESTRUCTURA DE LA FRONTERA DE GRANO

En este capítulo analizaremos la estructura de la frontera de grano a partir del desarrollo histórico de los modelos usados para explicarla geométricamente y explicar sus propiedades. Pondremos mayor énfasis en el modelo más riguroso y útil de todos: el modelo de coincidencia.

El término de "frontera de grano" es utilizando en esta tesis por su significancia histórica aunque un término como "frontera cristalina" puede ser más preciso.

Cuando la desorientación entre los granos es pequeña la frontera de grano se llama FRONTERA DE GRANO DE BAJO ANGULO (fig. 3) y su estructura fué descrita por medio de dislocaciones de borde. Si las fronteras son descritas por medio de dislocaciones de borde, la frontera se forma al girar un grano con respecto al otro alrededor de un eje el cual cae en el plano de la frontera, a tales fronteras se les conoce como FRONTERAS DE TILT (inclinación) (fig.1). Si los dos granos son girados uno con relación al otro alrededor de un eje perpendicular a la frontera, la frontera es llamada FRONTERA DE TWIST (rotación) (fig. 2) y puede ser descrita por dos conjuntos ortogonales de dislocaciones de tornillo.



Figura 1. Frontera de tilt



Figura 2. Frontera de twist

1.1 EL MODELO DE LA ESTRUCTURA AMORFA.

El modelo de la estructura amorfa para describir a la frontera de grano fué sugerida por Brillouin (1) y Quincke (2)y lo trabajaron en detalle Rosenhain y Ewen (3). En este modelo la frontera es considerada como un liquido sobreenfriado ya que mientras es muy duro y fragil a bajas temperaturas, a altas temperaturas es blando y viscoso.

Por medio de este modelo el deslizamiento de la frontera, observada a altas temperaturas, y la fragilidad a bajas temperaturas puede ser explicadas.

Sin embargo hay varias razones para eliminar esta hipótesis las cuales se basan en las propiedades termodinámicas de la frontera. Si una frontera de grano fuese amorfa tendría la misma energía libre que el cristal en el punto de fusión, pero la evidencia experimental (30) sugiere que la energía libre de la frontera no varía tan rápidamente con la temperatura. Además, el espesor de la frontera estimada a partir de este modelo es más grande que la observada con el microscopio electrónico (aproximadamente de dos diámetros atómicos). Si la estructura de la frontera es amorfa, todas las fronteras deben tener las mismas propiedades, pero los experimentos indican que dependen de las relaciones de orientación de la frontera.

1.2 EL MODELO DE ISLAS

El modelo de islas está basado en la suposición de que una frontera consiste de islas donde el arreglo atómico es bueno, separado por regiones de arreglo pobre. Este modelo fué propuesto por Mott(4) y ligeramente modificado por Ke(5).

El modelo fué propuesto para explicar los altos valores de la entropía durante la migración de la frontera de grano obtenida de los resultados experimentales. Se postuló que la migración de la frontera de grano ocurre por el desorden de los átomos cerca de la región de pobre arreglo y que el mismo número de átomos "cristalizan" en otro cristal.

Gifkins(6) desarrolló el concepto de modelo de islas en el cual la frontera de grano consiste de islas de buen arreglo separadas por canales de vacancias relajadas. Varias propiedades de la frontera se pueden discutir con este modelo: segregación, difusión y energía interna.

## I.3 EL MODELO DE DISLOCACIONES

La deformación plástica fué estudiada durante la década de los 30's lo que contribuyó a la formulación de la teoría de las dislocaciones para explicar la estructura de la frontera de grano.

El modelo de dislocaciones para fronteras de bajo ángulo fué propuesto por Bragg y Burgers quienes demostraron que una cadena de dislocaciones pueden producir un cambio de orientación del cristal a través del plano de la cadena(7 y 8).

La figura 3a muestra un cristal csl que tiene un eje común y su diferencia en orientación es definida por la rotación relativa O alrededor de su eje común. En la figura 3b los dos granos son unidos para formar un bicristal en donde es desajuste es acomodado por medio de dislocaciones de borde. A partir de esta figura se deduce que el espaciado D entre las dislocaciones está dado por:

 $D = b/\theta$ 

para 0 pequeño, de ahí el nombre de estas fronteras. Un argumento físico simple (9) dá la energía de la frontera de grano E en función de 0:

 $E = E_0 \Theta (A - 1n\theta)$ 

donde E<sub>o</sub> es evaluado en regiones donde la deformación es elástica y el parámetro A depende de la energía del centro de la dislocación.

El modelo de dislocaciones, que fué inicialmente desarrollado para fronteras de bajo ángulo, puede extenderse sobre una base puramente geométrica a las fronteras de alto ángulo. El modelo de Read-Shockley (9) está basado



Figura 3

en la consideración de que como la energía de una frontera de bajo ángulo es relativamente baja si el espaciado entre dislocaciones es uniforme, si se supone que el espaciado es uniforme en una frontera de grano de alto ángulo para las dislocaciones entonces su energía es relativamente baja. Un espaciado entre dislocaciones es uniforme en una frontera de alto ángulo si este espaciado es un número entero de planos de la red que terminan en la frontera. La frontera de la figura 4 tiene una dislocación por plano de la red, por lo tanto tiene un espaciado uniforme.

Li(10) intentó extender el modelo de dislocaciones de Read-Shockley con énfasis sobre los efectos de los centros de las dislocaciones. Se supone que la teoría de la elasticidad lineal es válida para las fronteras de alto ángulo. Lo que se calculó fué que la estructura de las dislocaciones cambia con respecto al ángulo (fig. 5).





El hecho de que varias propiedades de la frontera (difusión, segregación, y migración) derivados en este modelo no concuerden con los resultados experimentales se debe a que no se toma en cuenta que en la mayoría de las fronteras la ley de Hooke no es válida.

El modelo de Peierls (11) considera a la frontera como una región formada de dislocaciones parciales con lo que es posible explicar las diferentes separaciones de equilibrio entre las dislocaciones individuales y las dislocacio<u>n</u>es que forman a la frontera de alto ángulo.



Figura 5.- Forma de los centros de las dislocaciones con respecto al ángulo de orientación relativa.

# 1.4 EL MODELO DE SITIOS DE COINCIDENCIA.

Este modelo fué elaborado por Dunn (12), Ranganathan (13), Bollmann (14) y Frank (15). La figura 6 muestra un ejemplo de red de coincidencia. Tenemos dos cristales cúbicos, marcados por los símbolos + y o, sobrepuestos inicialmente tal que coincidan los puntos de ambos. Los dos cristales son girados uno con respecto al otro por 36.9° alrededor de un eje norma a el papel que pasa por el centro. Los puntos marcados con • ocupan sitios de la red donde ambas redes coinciden después de rotar. Estos "sitios de coincidencia" comprenden una nueva red tridimensional con una celda unitaria más grande que la de los dos cristales.

Sólo para ángulos específicos de rotación se obtienen altas densidades de sitios de coincidencia mientras que para otros existen pequeños números de sitios de coincidencia (tabla I (31)). Figura 6.-  $36.9/<100>, \Sigma=5$ 

Un bicristal real puede ser dibujado introduciendo un plano de frontera en la red de sitios de coincidencia y permitiendo que los átomos ocupen los sitios de coincidencia del primer cristal de un lado de la frontera y los sitios del segundo cristal en el otro lado de la frontera.

Para caracterizar una red de coincidencia, al igual que cualquier red, es necesario especificar una red de Bravais, las dimensiones a'b'c' de su celda unitaria y sus mutuas inclinaciones. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de su red puntual, se usa el parámetro  $\Sigma$  que se define como "la razón del número total de sitios en una celda unidad de la superestructura asociada con cada red de sitios de coincidencia a el número de sitios de coincidencia". Friedeí '(32) demostró que tiene valores impares en el sistema cúbico, siendo el valor más bajo ( $\Sigma = 1$ ) el caso de un cristal y el valor  $\Sigma = 3$  un sistema de coincidencia muy importante: el twin (gemelo).

#### TABLA I

Pares eje-ángulo para fronteras de coincidencia en sistemas cúbicos hasta $\Sigma$  = 19, "a" y "b" disntinguen pares de diferentes redes de sitios de coincidencia con los mismos valores de  $\Sigma$ .

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Σ	۳. آ	2	h•	Σ	0.	Σ	0°
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Axis	(522)	(410) Axis		(221) Axis		(100) Axis	
2807 17a 90-00 9 152-73 9 1 36-87 5 112-62 13b 180-00 17a $<$ 300 Axis 3513 5 143-13 5 142-14 190 173 17a 280-00 9 $<$ (411) Axis 180-00 17a 12-2 13a 17a 280-00 9 $<$ (411) Axis 180-00 17a 12-2 13a 190 Axis 129-52 11 $<$ 311) Axis 12-2 13a 12-2 19a 100 Axis 129-52 11 $<$ 311) Axis 18-07 17a $<$ 3100 Axis 153-47 190 99-59 15 18-07 17a $<$ 3100 Axis 153-47 190 99-59 15 18-07 17a 115-38 7 $-$ 160-81 $>$ 160-81 9 $>$ 12-22 11 41-13 5 91-02 19a 100 11 $<$ 4212 Axis 180-00 19b 100 19b 100-15 10 100 19b 100 110 100 19b 100 19b 100 110 100 19b 100 110 19b 100 100 110 100 19b 100 110 100 19b 100 110 19b 100 110 19b 100 110 19b 100 100 110 19b 100 100 110 100 19b 100 100 100 100 100 19b 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		175	160.25	136	107.92	175	61.93	13a	22.62
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				9	152.73	9.	90-00	17.	28-07
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Axis	<530>	178	180.00	136	112.62	5	36-87
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		195	142-14			5	143-13	5	53-13
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		17a	180-00	xis	(411)	9.	180-00	178	61.93
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				17a	93 37	he in the		13a	67-38
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Axis	<531>	11	129.52			13.4	12.62
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	and the second	15	99.59	196-00	151.47	Axis	(310)	17a	18 07
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	126-22		180.00	136	76.60	5	26.87
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	a an creation i f		160-81		para sera da pod	194	93-02	5	43-13
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						ា	115-38	174	51-93
57-36       13a       160-00       5       113-58       15       (532) Axis         26-53       19a       50-70       15       (410) Axis       (533) Axis         26-53       19a       50-70       15       (410) Axis       (533) Axis         38-94       9       67-11       9       118-07       17b       105-35       37a         38-94       9       67-11       9       118-07       17b       105-35       37a         38-94       9       67-11       9       118-07       17b       105-35       37a         30-48       11       95-74       5       57-38       13b       10-34       13b         10-33       177b       180-00       13b       162-46       11         93-37       17b       180-00       13b       10-01       19b         29-52       11       (320) Axis       137-17       15       (551) Axis         140-00       7       137-31       17a       15         (11)       Axis       149-00       7       137-31       17a         (21) Axis       180-00       13a       (432) Axis       165-16       15         (317)				Axis	(421)	11	144-90	17:	51-93
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Axis	<\$32>	15-	113-58	5	150-00	13a	57.38
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		195	180-00	11	155-34		le marte de la composition de la compos	i i en el	e an
26:53       19a       50-70       15 $\langle 430 \rangle$ Åxis $\langle 533 \rangle$ Åxis         38:94       9 $67:11$ 9       118:07       17b       105:15       17a         38:94       9 $67:11$ 9       118:07       17b       105:15       17a         38:94       9 $67:11$ 9       157:38       1.15       100:53       17a         30:70       15       17b       140:44       3 $\langle 431 \rangle$ Axis       162:06       11         86:65       17b       140:44       3 $\langle 431 \rangle$ Axis       162:06       11         90:47       3       117:15 $\langle 551 \rangle$ Axis       134:43       15         90:47       3       110:00       13b       110:01       19b         29:52       11 $\langle 320 \rangle$ Axis       13:43       15         153:47       19a $\langle 100:48$ 11       12:76       19a $\langle 111 \rangle$ Axis       14:9:00       7       137:33       17a $\langle 112 \rangle$ Axis       180:00       13a       (413) Axis       16:53       19a $\langle 212 \rangle$ Axis       180:00       13a       16:133       19a       19a <td></td> <td>ير المؤدي شده معني م الم المؤدي في ال</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Axis</td> <td>(311)</td> <td>Axis</td> <td>&lt;110&gt;</td>		ير المؤدي شده معني م الم المؤدي في ال				Axis	(311)	Axis	<110>
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Axis	(\$33>	Axis	(430)	15	50.70	19a	26-53
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		174	105-35	175	118-07	9.	67.11	9 •	38-94
70:51       3:       117:82       15       162:46       11         86:61       17b       146:44       3 $\langle 431 \rangle$ Axis       (551) Axis         99:37       17b       180:00       13b       110:01       19b         29:52       11 $\langle 320 \rangle$ Axis       134:43       15         41:06       9       71:59       19b $\langle 432 \rangle$ Axis       164:06       13a         53:47       19a       100:48       11       121:76       19a       164:06       13a         (11)       Axis       149:00       7       137:31       17a       17a         27:80       13b       180:00       13a       (433) Axis       165:10       15         38:21       7       142:14       19a       (610) Axis       60:00       13       19a         31:71       19b       123:75       9       (441) Axis       180:00       19a       19a         73:17       19b       123:75       9       (441) Axis       180:00       19a       19a       19a       19a         137:17       15       (510) Axis       180:00       19a       100:1       9a       19a       19a       19a		130	130-13	135	157-38	5	95-74	11	50-48
86.63       17b       14b-44       3 $\langle 431 \rangle$ Axis         93.37       17b       180-00       13b       110.01       19b         29.52       11 $\langle 320 \rangle$ Axis       134-43       15         41-06       9       71-59       19b $\langle 432 \rangle$ Axis       164-40       13a         153-47       19a       100-48       11       121-76       19a       155-47         153-47       19a       100-48       11       121-76       19a       155-10       15         153-47       19a       160-00       7       137-3.3       17a       17a         27-80       13b       180-00       7       137-3.3       17a         17b       13b       180-00       17b       (610) Axis         60-00       13       86-18       15       161-33       19a         7       150-07       15       160-25       17a       (610) Axis         81-79       7       150-07       15       (611) Axis       180-00       19a         127-7       7       150-07       15       (711) Axis       166-83       19a       15       180-00       19a       134-43       15		11	162.66			15	117-82	3 <b>3</b> 5 5 5	70.53
93-37 17b 180-00 11 137-17 15 (551) Axis 99-47 3 180-00 13b 110 01 19b 134-13 15 141-06 9 7 71-59 19b (432) Axis 164-06 13a 153-47 19a 100-48 11 121-76 19a 121-97 17b 158-96 15 (553) Axis (111) Axis 149-00 7 137-33 17a 127-80 13b 180-00 13a (433) Axis 165-16 15 18-21 7 142-14 19a 46-83 19b (321) Axis 180-00 17b (610) Axis 81-79 7 1 150-07 15 160-25 17a (611) Axis 180-00 19a (441) Axis 81-79 7 1 150-07 15 160-25 17a (611) Axis 180-00 19a (511) Axis 180-00 19a 147-80 13b (3000 7 180-00 19a 110-01 19a 147-80 13b (322) Axis 180-00 7 180-00 19a 147-80 13b (322) Axis 180-00 7 180-00 19a 147-80 13b (322) Axis 180-00 7 180-00 19a 158-21 7 137-17 15 (711) Axis 152-73 9 (511) Axis 130-00 19a 152-73 9 (611) Axis 130-00 19a 152-73 9 (731) Axis 137-33 17b (210) Axis 180-00 17b (511) Axis 137-33 17b (210) Axis 180-00 19a 121-7 (732) Axis 154-16 15 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 153+16 5 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 154-16 5 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 154-16 5 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 154-16 5 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 154-16 5 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 154-16 5 (520) Axis 139-74 19b (211) Axis 180-00 19a 121-70 19b 166-07 17b 154-16 5 (520) Axis 139-74 19b 154-16 15 (332) Axis 139-74 19b 155-76 15 (332) Axis 139-74 19b		355 B. 18 - 18 -		Axis 👘	(431)	3	146-44	176	86-63
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Axis	(551)	15	137-17	11	180.00	175	93.37
29-52       11 $\langle 320 \rangle$ Axis       134-43       15         41-06       9       71-59       19b $\langle 432 \rangle$ Axis       164-00       13a         153-47       19a       100-48       11       121-77       17b       158-76       19a         (111)       Axis       149-00       7       137-31       17a         27-80       13b       180-00       13a $\langle 433 \rangle$ Axis       165-10       15         38-21       7       142-14       19a       (610) Axis       6600       Axis       1661-33       19a         46-83       19b       (321) Axis       180-00       17b       (610) Axis       6610) Axis         80-18       15       -       161-33       19a         73.17       19b       123-75       9       (441) Axis       180-00       19a         81-79       7       150-07       15       160-25       17a       (611) Axis       180-00       19a         147-80       13b       -       (510) Axis       180-00       19a       110-01       19a         180-00       3       107-92       13a       110-01       19a       134-43       15	an a	196	11001	136	180-00			3	09.47
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	e gli e taka Di saka sa ta	15	13443			Axis	(320)	11	29-52
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		13a	164.06	Axis	(432)	196	71.59	· 9 ·	141-06
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			이 이 같아.	194	121.76	11.	100-48	19a	153-47
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Axis	(553)	15	158-96	176	121.97		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		17a	137.3.3			7	149.00	Axis	(111)
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		15	165.10	Axis	(433)	13a 👘	180-00	136	27.80
46:83       19b $(321)$ Axis       180-00       17b       (610) Axis         60:00       13       86:18       15       -61:33       19a         73:17       19b       123:75       9       (441) Axis       180:00       19a         81:79       7       150:07       15       160:25       17a       (611) Axis         92:20       13b       180:00       7       180:00       19a         147:80       13b       .       C\$105 Axis       .       .         158:21       7       .       137:17       15       .       .         166:83       19b       (322) Axis       180:00       13a       110:01       19a         180:00       3       107:92       13a       .       .       .       .         180:00       17b       .       .       .       .       .       .       .         (210) Axis       180:00       17b       .				194	142.1.1			7	38-21
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Antonio († 1919)	Axis	(610)	175	180-00	Axis	(321)	196	46-83
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		194	161-33			15	86.18	13	60-00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Axis	(441)	9	123.75	196	73.17
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Axis	(611)	17a	160-25	15	150.07	· 7 ·	81.79
147-80       13b		19a	1 80.00			7	180-00	136	92.20
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			. 영문원	Asis	(510)			136	147-80
166-83       19b $\langle 322 \rangle$ Axis       180-00       13a       110-01       19a         180-00       3       107-92       13a       134-43       15         152-73       9       164-06       13b         (210) Axis       180-00       17b       (511) Axis         48-19       15       73-17       19a       (731) Axis         73-40       7       (331) Axis       92-20       13a       137-33       17b         96-38       9       63-82       17b       120-00       9       165-16       15         131-81       3       82-16       11       155-21       7       (733) Axis       120-00       9       165-16       15         131-81       3       82-16       11       155-21       7       (733) Axis       130-14       130-14       130-14       140-14       15       15       15       15-16       15       15       15       15       16       15       15       16       15       16       16       15       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       16       17b       16       16		Anis	(711)	15	137.17			7	158-21
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		19.1	1 10-01	13a	180-00	Axis	(322)	195	166-83
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		15	* 34-43			13a	107.92	3	180-00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		136	164-06		•	9	1 52.73	•	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			6-33-5	Axis	(511)	175	180.00	) Akis	(210
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		> Axis	(731	19a	73.17			15	48.19
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		175	137-33	13.	92.20	Axis	(131)	7	73.40
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		15	165.16	- n	170-00	171	63.82	9	96.38
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				• -	154.71	11	82.16		111-81 -
154-16     5     (520) Axis     139-74     19b       (211) Axis     180-00     19a     121-76     19b     166-07     17b       62-90     11     158-96     15     15       78-46     15     (332) Axis     15       101-54     5     99-08     19a     (521) Axis       135.89     7     131.41     120-88     17b	de Jambé et de la	> Axis	/711				110.03	< .	18().(9)
(211) Axis 180.00 19a 121.70 19b 166.07 17b 62.90 11 158.90 15 78.46 15 (332) Axis 101.54 5 99.08 19a (321) Axis 135.59 7 111.41 19a 130.98 17b (751) Avie		195	119.74	Avit	(510)	<u> </u>	151.16		100.00
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		176	166-07	INIS	121.24	10-	180.041	1 X & v to	
78 - 16 15 (332) Axis 101 - 54 5 99-08 19n (521) Axis 135 - 54 7 111.41 12n 130.88 17b (751) Axis	and a state of the second s	tin an	, 100 U (	170	141770	- i 30 🤤	100.00		(11) مراجع
101.54   5   99.08   19n   (521) Axis 101.54   5   99.08   19n   (521) Axis 135.54   7   111.41   120.5   175   (751) Axis			일 같 같 같		ועיהכו		/277	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	78.14
101/04 - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο - Ο -	per la companya de la	이 같은 것이 같이 같이 같이 같이 같이 같이 한다.		A		100	2000	, i J , z	10.40
		. A vie	1761	176	120.00		50°27	2	101734
12223 $1223$ $1223$ $1233$ $1233$ $1233$ $1223$ $1223$ $1232$ $1232$ $1232$ $1232$ $1233$		10-	146.97	10	120.04	1.58	133.94		1.12.28

Ranganathan (13) reportó un método para generar sitios de coincidencia que podemos resumir de la siguiente forma: sea R la razón axial de la celda unidad en el plano (hkl) restringida a valores racionales, entonces el ángulo de rotación es

$$\theta = 2 \tan^{-1}(y/x) \cdot R$$

y la razón de área es

 $\Sigma = x^2 + R^2, y^2$ 

donde x y y son enteros,  $R = (h^2 + k^2 + 1^2)^{\frac{1}{2}}$ .

A partir de la discusión presentada se deduce que la red de coincidencia es una construcción puramente geométrica y que requiere únicamente dos cristales sobrepuestos que tienen sitios de la red comunes y, entonces, la red de coincidencia no requiere una frontera de grano entre lad dos redes.

Fué el trabajo de Kronberg y Wilson (17) el que sugirió, en base a las observaciones de texturas de recristalización en Cu, que las fronteras obedecían relaciones de coincidencia y que mostraban propiedades (p. ej. altas velocidades de migración) diferentes a las fronteras de no coincidencia.

Basado en el concepto de sitios de coincidencia y en el modelo de dislocaciones, Brandon (18) propuso un modelo detallado para la estructura de una frontera de alto ángulo. Las ideas básicas del modelo se pueden entender considerando los siguientes casos límites:

- Cuando los dos cristales tienen una relación de orientación de coincidencia y cuando la frontera puede tener cualquier inclinación, se propuso que la frontera se encuentra en el plano de alta densidad de sitios de coincidencia ya que con esto la frontera tendrá un pequeño espesor, un campo de esfuerzo de largo alcance despreciable y baja energía (AB o CD de la figura 7a).
- 2) Si la frontera hace un ángulo con los planos densamente compactos de la red de coincidencia tenderá a hacer una estructura escalonada de tal forma que tendrá una área superficial máxima en los planos de alta densidad de sitios de coincidencia (BC de la figura 7a).
- 3) Si suponemos que la frontera cae en un plano de alta compacidad de la red de coincidencia pero las relaciones de orientación de los dos granos se desvía ligeramente de la relación de coincidencia ideal entonces se describirá como una cadena de dislocaciones sobrcimpuestas en la frontera de coincidencia ideal (fig. 7b). La existencia de tales cadenas de dislocaciones en la frontera de grano han sido confirmadas por Schober y Balluffi (19) usando microscopía electrónica.

## 1.5 EL MODELO DE LA "O-LATTICE"

No hay otros modelos de la estructura de la frontera de grano de alto ángulo que tengan el rigor cristalo-



(a)

(b)

Figura 7

gráfico de la teoría de coincidencia excepto para el modelo de la O-Lattice que Bollman desarrolló en 1967 (20).

Consideremos las coordenadas de un punto arbitrario dentro del cristal, p. ej. (12, 138, 7.243,-4.421), designamos como coordenadas externas a los enteros (12,7,-5) y como coordenadas internas a (0.138,0.243,0.579). Entonces, las coordenadas internas designan las posiciones del punto dentro de la celda unitaria y las coordenadas externas designan la posición de la celda unidad.

Un bicristal puede construirse a partir de un estado inicial (21) considerando dos redes sobrepuestas A y B (fig. 8). Para todo punto de la red  $M_B$  de E, su vecino más cercano de  $M_A$  en la red A debe ser determinada.



Analíticamente, una transformación lineal T que transfiera la red A a la B es escogida de tal forma que, en la vecindad del origen común O, el vecino más cercano de  $M_B$  es su origenal  $M_A$ . Cuando A y B son redes de traslación, cuya propiedad es que si formamos el conjunto de todos los vectores de diferencia posibles entre puntos arbitrarios de una red y los trasladamos a que comiencen de un origen común, sus puntos de nuevo formarán la red original. Ha sido mostrado que hay muchos puntos O', análogos al origen O, al-rededor del cual el vecino más cercano al punto de la red  $M_B$  en la red A puede encontrarse.

En la figura 8 se muestra la búsqueda de los vecinos más cercanos de  $M_B$  en la red A cercano al origen 0. El vecino más cercano de  $M_B^\circ$  es  $M_A^\circ$  que se encuentra transformandolo por una rotación  $\Theta$  alrededor de 0. Cuando  $M_B$ está más lejos del origen, su vecino está más cerca,  $M_A^2$  que se encuentra transformandolo por la misma rotación pero ahora alrededor de O'. O' es un punto de la O-Lattice.

La O-Lattice la podemos definir como la red e todos los posibles origenes de los cuales una red A puede ser producida a partir de una red B dada por una transformación lineal T. La O-Lattice puede consistir de puntos, líneas o planos los "elementos O" que consisten de "O-puntos".

Puede notarse que si un O-punto tiene todas sus coordenadas internas iguales a cero entonces es un punto de ambas redes y se tiene una red de coincidencia; por esta razón la O-Lattice es una generalización del concepto del modelo de coincidencia. Pero hasta ahora no se ha observado estructuras de metales que puedan ser interpretados en términos de la O-Lattice.

## 1.6 EL MODELO DE LA UNIDAD ESTRUCTURAL

Los modelos para la frontera de grano hasta ahora discutidos estas esencialmente basados en consideraciones geométricas. Pero la estructura de una frontera no es gobernada por principios geométricos sino por el principio termodinámico de que la energía libre de un sistema es mínima. Esto puede ser más apropiado para discutir la estructura de la frontera de grano.

Supongamos, por lo tanto, que los átomos en las regiones de las fronteras de grano pueden ajustar sus posiciones para incrementar la fuerza de las fronteras. El

acomodamiento de cada cristal con el otro puede consistir de dos partes: a) la relajación local de los átomos individuales de la frontera hacia las posiciones que disminuyan la energía libre, y b) una distorsión elástica de largo lacance de ambos cristales atrayendo más átomos a la frontera.

Pero, ¿cómo se ajustan los dos cristales en la frontera de grano?. En la figura 9 los átomos que ocupan sitios de coincidencia estan marcados por A,B,C,D, y E y de acuerdo con el modelo de coincidencia corresponde a un arreglo de baja energía. Trasladando el cristal de arriba con respecto al de abajo sin remover los átomos de sus sitios correspondientes en la red y los llevamos tan cerca como sea posible sin solaparlos (fig. 10) esperandose que este arreglo tenga una energía menor que la configuración de coincidencia. Los cálculos computacionales (33) para la energía de ambos arreglos lo confirman. Sin embargo la frontera mostrada en la figura 10 no puede describir la estructura actual de la frontera ya que la relajación de los átomos de su sitio correspondiente puede resultar en un decrecimiento de la energía. En la figura 11 se muestra un arreglo calculado por Weins y Gleiter de la energía más baja de los átomos de la frontera de tilt de 38° y se supone que esta configuración representa la estructura actual de la frontera.

La única propiedad geométrica que queda inalterada durante la traslación de los dos cristales y la relajación de los átomos individuales es la periodicidad del arreglo atómico en la frontera. Por lo tanto, el criterio para las



Figura 9

Figura 10

Figura 11

fronteras "especiales" es la periodicidad del arreglo de los átomos en la frontera sugiriendo que una estructura corta y periódica puede ser la condición geométrica para las fronteras "especiales".

Si nos apartamos de las posiciones de simetría no cambia drásticamente la estructura de la frontera de grano; toda la frontera es obtenida repitiendo su unidad estructural periódicamente.

#### 1.7 PROPIEDADES DE LAS FRONTERAS DE GRANO

Vamos a puntualizar la relación entre la estructura de la frontera de grano y sus propiedades con ayuda de los modelos antes vistos. 1.7.1 Migración de la Frontera de Grano

La migración de la frontera de grano es definida como el desplazamiento de una frontera normal a su plano tangente debido a la transferencia de átomos de un cristal al otro a través de la frontera.

Para estudiar este proceso se han empleado dos métodos:

- La observación del movimiento de una frontera en un bicristal, y
- la medida del tamaño de grano promedio durante el crecimiento de grano.

Los resultados obtenidos por ambos tipos de experimentos indican que la velocidad de migración de una frontera depende de los siguientes parámetros:

- a) La relación de orientación de los granos (es mayor en las fronteras cercanas a la relación de coincidencia).
- b) La inclinación de la frontera (en metales fcc las fronteras de tilt tienen alta movilidad con respecto a las de twist; para bcc tenemos lo contrario).
- c) La fuerza motora (la movilidad es proporcional a la fuerza motora).
- d) El contenido de la aleación.

Para entender estos resultados debemos conocer el mecanismo por el que un átomo es transferido de un cristal a otro a través de la frontera. En fronteras de grano de Al-Cu, Gleiter (22) observó un patrón de líneas débiles cuyas

propiedades sugieren que las líneas representan "escalones" en la frontera. Por lo tanto, la frontera puede ser considerada como un sistema de escalones en las "superficies" de los granos. Cada escalón está formado por un plano de empaquetamiento compacto de uno de los cristales que terminan en la frontera. Gleiter concluye que la migración de la frontera de grano ocurre por la transferencia de átomos (probablemente difusión en la frontera de grano) de un escalón de un cristal a los escalones de los otros cristales (del átomo A de la figura 12 a la posición B) de lo que resulta un desplazamiento de la frontera de grano normal a su plano tangente.



Figura 12

1.7.2 Segregación en la Frontera de Grano

La concentración de átomos de soluto en la región de la frontera de grano puede variar apreciablemente del contenido promedio de soluto en el cristal. Este efecto es llamado segregación en la frontera de grano.

Varios métodos directos, como espectroscopía Auger, microanálisis, autoradiografía, microscopía de campo iónico, dispersión inelástica y varios métodos indirectos como ataque a la frontera de grano. observación de rayos X, medidas de la constante de la red, medidas de resistividad y microdureza, han dado una cantidad sustancial de datos experimentales sobre la segregación de átomos de soluto en la frontera de grano (23) de donde se concluye que la segregación en la frontera de grano está basada en las fuerzas interatómicas entre los átomos de soluto y la frontera y que la intensidad de estas fuerzas depende de las relaciones de orientación entre los cristales y las propiedades de los átomos de soluto.

La segregación en la frontera de grano puede ser importante para la corrosión de la frontera. Debido a que la energía libre de ciertas fronteras de coincidencia es apreciablemente más baja que la energía de otras fronteras, las fronteras de coincidencia son elegidas para tener una menor velocidad de corrosión siempre <u>que no ocurra la se-</u> gregación.

1.7.3 Deslizamiento de la Frontera de Grano

El deslizamiento de la frontera de grano es la traslación relativa de dos cristales en la frontera de grano. El deslizamiento sobre distnacias microscópicas (>lum) parecen ser posibles solamente si la temperatura está por arriba del 40% de la temperatura absoluta de fusión.

A partir de los resultados de numerosos experimentos (24 a 26) se tiene los siguientes hechos:

2.0

- a) El deslizamiento de la frontera de grano es un proceso termicamente activado, y su energía de activación está entre la energía de activación para la difusión en la frontera de grano y la autodifusión en la red.
- b) La razón de deslizamiento se incrementa cuando se incrementa el esfuerzo de deformación en el plano de la frontera.

Recientes observaciones por microscopía electrónica de transmisión (27 a 29) han sugerido que el deslizamiento de la frontera de grano ocurre por el movimiento de dislocaciones en la frontera de grano. Dos tipos de dislocaciones encontramos: dislocaciones de red y dislocaciones en la frontera de grano. En ambos casos el deslizamiento de la frontera de grano puede visualizarse como el movimiento de estas dislocaciones en el plano de la frontera. El movimiento de las dislocaciones de la red a lo largo de la frontera en general requiere de ascenso y deslizamiento ya que su vector de Burgera no será paralelo al plano de la frontera.

El movimiento conservativo de dislocaciones dentro de una área limitada de la frontera es posible si el deslizamiento de la frontera de grano ocurre por dislocaciones de frontera de grano (fig. 13). Esta dislocación tiene un vector de Burgers que es igual a la periodicidad de la estructura de la frontera de grano. La dislocación de la frontera de grano en el plano de la frontera es igual a la dislocación de la red en el plano de deslizamiento.



Figura 13.- Modelo de una dislocación en la frontera de grano. a) Frontera libre de dislocaciones y b) la misma frontera conteniendo una dislocación en la frontera de grano.

El movimiento conservativo de las dislocaciones en la frontera de grano está limitada por el área sobre la cual una frontera de grano es, a nivel atómico, plana. Por ejemplo, en el segmento AB (fig. 14) las dislocaciones pueden moverse en forma conservativa únicamente entre A y B, entonces al aplicar un esfuerzo de deformación ( $\mathbf{T}$ ) se espera que las dislocaciones en la frontera de grano se muevan conservativamente dentro de los segmentos AB,BC, y CD.

Como resultado de este movimiento tenemos una alta velocidad de deslizamiento. Sin embargo, esta velocidad decrecerá debido a que las dislocaciones se apilan en las esquinas de los segmentos de los planos de las fronteras. El esfuerzo causado por este apilamiento crecerá hasta que una ce sus componentes balancea el esfuerzo aplicado cesando, si ro ocurre otro proceso que remueva a las dislocaciones en la frontera de grano de su apilamiento, el desplazamiento de la frontera.



Las dislocaciones en la frontera de grano pueden ser removidas por dos mecanismos: a) por procesos de difusión controlada o b) por generación de dislocaciones cristalinas. Las observaciones experimentales sugieren que es el esfuerzo aplicado el que determina el mecanismo dominante.

A altas temperaturas, el esfuerzo desarrollado por el apilamiento de dislocaciones en las esquinas (fig. 14) produce un flujo difusivo de materia de las partes en comprensión de la frontera a aquellas partes de tensión. Este flujo puede ser interpretado como el ascenso de las dislocaciones en la frontera de grano de un segmento, digamos AB, hacia un segmento vecino, BC, y víceversa.

Si se aplica un esfuerzo suficientemente grande, el flujo plástico de los cristales ocurre en la vecindad de la frontera de grano lo cual incluye el movimiento de dislocaciones (fig.15).



Figura 15

La dislocación en la frontera de grano del segmento AP (vector de Burgers  $\underline{b}_1$ ) es apilado bajo la influencia de un esfuerzo aplicado frente a P. Estas dislocaciones no pueden moverse conservativamente hacia el segmento de la frontera PB. Si el esfuerzo aplicado es pequeño, la dislocación se desliza hacia el segmento de la frontera PB y su movimiento será de difusión controlada. Si el esfuerzo es grande, el esfuerzo se concentra en P resultando la generación de una dislocación cristalina ( $\underline{b}_0$ ). En un caso especial  $\underline{b}_2$  puede ser paralelo a el segmento PB. Se concluye, por lo tanto, que hay un flujo disfusivo de materia en la frontera de grano y la generación de dislocaciones.

#### CAPITULO II

#### MICROSCOPIA ELECTRONICA

Debido a que los resultados de esta tesis dependen de la interpretación de las fotografías obtenidas en el microscopio electrónico, la formación de contraste en la imagen de este instrumento es considerada en detalle. Explicaremos los fenómenos que ocurren cuando los electrones interactúan con la materia y formularemos una teoría aceptable (1,2,3 y 7).

#### 2.1 GENERALIDADES

En esta parte describiremos brevemente el funcionamiento del microscopio electrónico.

Existen varios tipos de diseño para un microscopio electrónico que dependen de la información que se quiera extraer de la muestra observada ya que los procesos de interacción entre los electrónes y el sólido determinan diferentes modos de análisis y, por lo tanto, diferentes instrumentos detectores. No obstante, la obtención del haz electrónico es prácticamente la misma para la mayoría de los microscopios y consiste de un emisor termiónico adaptado a una lente electrostática que acelera los electrones hacia la muestra; la concentración del haz se logra mediante lentes condensadoras. Para enfocar el haz nos basamos en el hecho de que una partícula cargada viajando con una velocidad <u>V</u> en un campo electromagnético sentirá una fuerza expresada como:

$$\underline{F} = \underline{e}\underline{E} + \underline{e}(\underline{V} \times \underline{B})$$

donde  $\underline{E}$  y  $\underline{B}$  son las intensidades de campo eléctrico y electromagnético respectivamente. Los dispositivos diseñados para dirigir y enfocar haces de partículas cargadas se llaman "lentes" y hay dos tipos: electrostáticas y electromagnéticas.

En la lente electrostática cuando una partícula pasa por ella experimenta una fuerza dirigida con una componente hacia el eje central y gana un impulso en esa dirección, de manera que el haz se enfoca en algún punto. En la lente electromagnética se aprovecha el hecho de que una partícula cargada viajando en un campo magnético experimenta una fuerza perpendicular a su velocidad y a la dirección del campo, así que cuando el electrón alcanza la región del campo siente un impulso hacia el eje más una rotación alrededor del mismo.

Salvo la rotación mencionada, la analogía de estos dispositivos con las lentes ópticas es perfecta.

#### 2.2 FENOMENOS ASOCIADOS A LA INTERACCION ELECTRON-SOLIDO

Al incidir un haz de electrones sobre el material

ocurren varios procesos y cada uno de estos fenómenos provee de distinta información acerca del material estudiado. Estos son:

- 1) <u>Electrones Retrodispersados</u>: son aquellos que se desvían del haz hacia atrás debido a su dispersión elástica con los átomos de la red, su energía es cercana a la del haz incidente. Estos eventos se llevan a cabo cerca de la superficie, por lo que si barremos distintas zonas de la muestra tendremos variaciones en la intensidad de electrones retrodispersados a un ángulo dado, resultando una fotografía topográfica de la muestra. Además, la intensidad del haz retrodispersado está determinada por la probabilidad de que un electrón sea absorbida; entonces podemos esperar que la intensidad del haz retrodispersado aumente cuando se incremente el número atómico de los elementos que forman el sólido. Esto nos permite detectar zonas de diferente composición en el material.
- 2) <u>Electrones Secundarios</u>: son originados en el sólido y emitidos como resultado de excitación atómica por el haz primario y se caracterizan por tener un espectro de energía comparativamente bajo (<50 eV) en relación al haz inicial. La emisión de electrones secundarios depende tanto de la densidad como topografía del sólido, por lo que podemos formar con ellos imágenes parecidas a las de electrones retrodispersados.

- 3) <u>Electrones Absorbidos</u>: son electrones que pierden tal cantidad de energía que no pueden salir del sólido y pueden ser detectados si ponemos electrodos en la muestra de manera que cualquier exceso de carga fluya a través de ellos a tierra. Cualquier incremento local en el número de electrones dispersados o emitidos causa el decremento correspondiente de absorbidos, por lo que la detección de estos electrones produce un contraste complementario al obtenido en las dos anteriores al barrer la superficie de la muestra.
- 4) <u>Rayos X Característicos y Electrones Auger</u>: es de esperarse que se emiten rayos X característicos debido a las transiciones de los electrones excitados por el haz primario, por lo que si utilizamos un espectrómetro adecuado y un detector de estado sólido podremos construir un perfil de intensidades y conocer tanto los elementos que componen la muestra así como su concentración; es decir, podremos efectuar un análisis químico. Podría suceder que un átomo excitado regresara a un estado de energía menor emitiendo uno de sus electrones en vez de rayos X. Tales electrones son llamados Auger y se caracterizan por tener valores discretos bien definidos de energía y por lo tanto pueden usarse para un análisis químico.
- 5) <u>Electrones Transmitidos y Difractados</u>: estos son los electrones del haz inicial que logran atravesar la mues-

tra y llevan información sobre la estructura interna de la misma. La formación de una imagen a partir de estos electrones es lo que constituye la microscopía electrónica de transmisión.

De los fenómenos mencionados se puede inferir que tenemos dos posibles maneras de formar una imagen: una consiste en enfocar el haz sobre una área reducida de la muestra y barrer la superficie moviendo el haz y detectando en cada zona una intensidad promedio; esto es lo que se llama Microscopía Electrónica de Barrido (Scanning Electron Microscopy). La otra consiste en iluminar una área grande de la muestra con un haz fijo y adaptar un sistema electroóptico para la amplificación de la imagen; esto es lo que se llama Microscopía Electrónica Convencional.

2.2.1 Formación de la Imagen en el Microscopio Electrónico de Barrido

Debemos enfocar el haz sobre una área reducida de la muestra  $(=100 \text{ \AA})$ , esto lo hacemos colocando el área de observación en el plano focal de la lente objetiva. Los electrones emitidos por la muestra son recolectados con detectores apropiados y se utiliza para modular la polarización de reja de un tubo de rayos catódicos (TRC), de manera que se establece una correspondencia uno a uno entre la cantidad de electrones detectada y la intensidad del

punto correspondiente en la pantalla del tubo. La imagen completa de la muestra se construye finalmente por medio de un generador de barrido que deflecta tanto al haz incidente como al haz del TRC sincrónicamente de manera que a cada punto del área barrida de la muestra corresponde otro en la pantalla.

# 2.2.2 Formación de la Imagen en el Microscopio Electrónico de Transmisión

El micorscopfo puede ser operado de modo que produzca un patrón de difracción o una imagen del área iluminada por los electrones.

Una vez que los electrones dejan la lente objetiva, puede ponerse un diafragma en elplano focal del objetivo de manera que sólo permita pasar uno de los haces enfocados allí. Si se deja el transmitido, hacemos microscopía de campo claro; si se deja uno de los difractados para formar la imagen, se llama microscopía de campo obscuro.

Una pantalla fluorescente (o placa fotográfica) se coloca en el plano imagen de la lente proyectora, de manera que si existen diferencias en el número de electrones que llegan a cada punto, se registran las diferencias correspondientes de la luz emitida por la pantalla. Si la lente intermedia se enfoca, no en el plano de la primera imagen intermedia, sino en el plano focal del objetivo y la apertura del objetivo se quita, entonces se obtiene una ima-
ven del patrón de difracción formado allí. El área de la que se obtiene el patrón de difracción es la misma que la que se ve en el modo de imagen. Por lo tanto, para localizar dicha área con precisión se coloca un diafragma en el plano de la imagen. Este modo de operación se llama difracción de área selecta (SADIFF).

Sabemos que todos los instrumentos ópticos tienen una limitación básica debida a la difracción de la apertura de la lente. Si dicha apertura subtiende de un ángulo de 2**6** desde el foco, dos puntos adyacentes no pueden verse separados si la distancia entre ellos es menor que 🕹 (límite de re solución) que viene dada aproximadamente por:

### **§** = **≯**/sen**▲**

con el mejor de los microscopios 🙇 se aproxima al límite teórico de 🕊/2 y por lo tanto se espera que 🕉 sea del orden de la longitud de onda $oldsymbol{\lambda}$ . Esto es aplicable a un microscopio electrónico donde 💫 está dada en términos del voltaje de aceleración V y corregida relativisticamente per:

### $1 + h(2m_{\circ} Ve(1 + eV/_{2}m_{\circ}c^{*}))^{V_{2}}$

ya que

### m = m. (ev/m.c2 + 1)

Algunos valores de 🎗 para los potenciales comunmente usados **λ**(Å) V(KV) son: 50 0.0536 100 0.0370 200

0.0251

Por lo tanto, teóricamente, con aumentar el potencial de aceleración aumentaría la resolución hasta distinguir individualmente los átomos y detalles de su estructura. Desafortunadamente no es así debido a que todas las lentes tienen aberraciones.

2.2.3 Aberraciones

Sólo mencionaremos los puntos relevantes de las aberraciones que se presentan en las lentes electromagnéticas (1 y 2).

- a) <u>Coma</u>: proviene de diferencias en la distancia focal de los rayos que inciden en la lente haciendo un ángulo distinto de cero con el eje óptico; la imagen de un punto sobre el eje óptico adquirirá una forma elongada (parecida a una coma). Esta aberración se elimina por completo alineando el haz y corrigiendo la dependencia axial del campo de las lentes.
- b) <u>Curva del Campo</u>: consiste en que las distancias focales de puntos fuera del eje óptico no son iguales, los discos de confusión mínima no estará en el mismo plano, sino en una superficie curva, y por lo tanto la imagen no será enfocada en un plano. Se corrige de la misma manera que la coma.
- c) <u>Distorsión</u>: se manifiesta como deformación de la imagen causada por defectos en la geometría de las lentes. Su corrección es análoga a la coma.

- d) <u>Astigmatismo</u>: es causada debido a que las lentes no son axialmente simétricas, entonces la imagen producida por ellas es más definida en una dirección dada. Para corregirla se les añaden electroimanes a las lentes, produciendo pequeños campos elípticos controlables independientemente.
- e) <u>Aberración Cromatica</u>: se dá cuando los electrones que forman el haz no tienen todos la misma longitud de onda, al pasar por la lente se refractarán de manera distinta, dando lugar a variaciones en la distancia focal. Si el voltaje de aceleración V del microscopio cambia por ∆V el cambio en la distancia focal ∆f está dado por:

#### $\Delta f/f = K \Delta V/V$

donde K es una constante cercana a la unidad. La medida del disco de confusión alrededor de la imagen producido por el cambio  $\Delta f$  es equivalente a un disco de radio  $\Delta r$ en el plano objetivo dado por  $\Delta r = \blacktriangleleft \Delta f$ . Para que la aberración cromatica no afecte la resolución del microscopio es necesario que este disco sea más pequeño que el poder de resolución. Se corrige escogiendo adecuadamente las aperturas del sistema objetivo y teniendo un haz altamente monocromático ( $\Delta V/V$  sea muy pequeño).

 f) <u>Aberración Esférica</u>: esta aberración no es corregible, corresponde a la dependencia de la distancia focal con la apertura para rayos no paraxiables. Los rayos marginales se desviarán en su refracción, en tal forma que serán enfocados antes delfoco de los rayos paraxiales. Vemos entonces el compromiso que existe en escoger adecuadamente la apertura de la lente (que llamamos anteriormente B). Vamos a tomar a  $\int$  como una medida del disco de confusión. Debido a que por un lado el poder de resolución aumenta de acuerdo con  $\int \sqrt[3]{n}$ , y por otro lado, si se incrementa  $\swarrow$ , el radio del disco de confusión crece como  $\bigstar^3$ ; tenemos entonces que encontrar el valor de la apertura óptima que minimice:

$$S = C_e B^3 + \lambda/B$$

donde C<sub>e</sub> se conoce como coeficiente de aberración esférica y tiene valores típicos de 3mm para las lentes usadas en el microscopio electrónico. Un valor aproximado es  $A_{r} \approx \chi^{1/4}/C_e^{-1/4} \approx 0.005$  rad. Sustituyendo nos dá para V = 100 KV:

 $\int_{\min} \Im \chi^{3/4} c_e^{1/4} \Im 1.11 \text{ Å}$ 

#### 2.3 DIFRACCION DE ELECTRONES

Supongamos que un haz de electrones incide perpendicualrmente a la superficie de la muestra que es un sólido cristalino perfecto. Podemos visualizar al haz como ondas planas cuyo frente de onda es paralelo a la superficie del tristal y se mueve con una velocidad de fase constante: elhace la luz monocromática cuando pasa por una rejilla. Ya que hablamos de difracción, es conveniente explicar algunos conceptos claves (4 y 5).

2.3.1 Ley de Bragg, Ecuaciones de Laue y Amplitud de Dispersión

La ley de Bragg nos dá la condición para que haya interferencia aditiva de la radiación incidente, la cual es:

 $2 d sen \theta = n\lambda$ 

donde d es la distancia entre los planos de la red, 0 es el ángulo con el que incide el haz primario formado con la superficie del cristal. Esto es porque la interferencia aditiva se encuentra cuando la diferencia de caminos ópticos de la radiación dispersada por los planos sucesivos es un número entero n de longitudes de onda .

La reflexión de Bragg sólo ocurre para longitudes de onda **λ**\$2d, por lo que la luz visible no se puede utilizar para hacer difracción en cristales.

La deducción de Bragg suministra la idea de la interferencia construcitva de las ondas dispersadas por cargas puntuales situadas en los nodos de la red espacial. Cuando nos interesa la intensidad de la dispersión por una distribución espacial de los electrones dentro de cada celda, tenemos que realizar un análisis más profundo. El procedimiento de Laue consiste en sumar las contribuciones de las

ondas elementales dispersadas por cada elemento de volumen del cristal.

Cuando se tiene un solo centro dispersor, digamos un único electrón, la radiación dispersada puede expresarse como Aexp  $2\pi i(k_{\Sigma} - wt)$ , donde s es una distancia medida en la dirección en que ha sido dispersada la radiación, y k es la dirección de la radiación incidente. Sin embargo, si en vez de uno, tenemos dos centros dispersores, es necesario tomar en cuenta la diferencia de fase  $\emptyset_r$ , con lo cual la dirección dispersada debe escribirse como:

A  $exp(2\pi i(ks - wt) + i\theta_{n})$ 

A partir de la figura 16 se encuentra que la diferencia de fase estará dada por:

 $\emptyset_{\mathbf{r}} = 2 \mathbf{\pi} \mathbf{r} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k}') = 2 \mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{k})$ 

donde  $\underline{\mathbf{k}}_k$ , el vector de dispersión, se define como el cambio experimentado por el vector de onda  $\underline{\mathbf{k}}$ :  $\underline{\mathbf{k}}_k = \underline{\mathbf{k}} - \underline{\mathbf{k}}'$ .



Si consideramos un pequeño elemento de volumen dV, la radiación dispersada será:

A exp 
$$\left\{ 2\pi i (ks - wt) + i \theta_r \right\}$$
  $\left( \underline{r} \right) dv$ 

donde  $\P(\underline{r})$  es la densidad electrónica dada por la relación  $\int \P(\underline{r}) dr = Ze$ . Así, la razón de amplitudes entre la radiaátomo ción dispersada por un centro dispersor y un elemento de volumen dV es  $\P(\underline{r}) \exp(2\pi i \underline{A}\underline{k},\underline{r}) dV$ , y por lo tanto, la amplitud dispersada por un átomo será:

$$f = \int_{atomo} \mathbf{g}(\underline{r}) \exp(2\mathbf{\pi}i \underline{g}.\underline{r}) \, dV$$

ſ

Además 2sen $\theta/\lambda = 1/d = Ak = g y entonces 2\pi g.r = 4\pi sen<math>\theta$  rcos $\theta'/\lambda$ = sr cos $\theta'$  siendo  $\theta'$  el ángulo entre g y r y s = 4\pi sen $\theta/\lambda$ .

Si el dispersor es esféricamente simétrico 
$$g(\underline{r})$$
  
 $g(r) y$   
 $f = \int_{0}^{\infty} 4\pi r^{2} g(r) \frac{sen rs}{rs} dV$ 

que es la amplitud de dispersión para rayos x.

De la teoría de dispersión sabemos que: ¥= ¥ incidente + ¥ dispersada donde la función de onda dispersada se expresa en términos de la onda esférica incidente y la amplitud de dispersión f(0;40), de la siguiente forma:

$$\frac{\mathcal{H}_{dispersada} = f(\theta, \boldsymbol{\ell}) \exp(2\pi i kr)/r}{f(\theta, \boldsymbol{\ell}) = \frac{2\pi m_{\theta} \boldsymbol{\ell}}{h^{2}} \int V(\underline{r}_{i}) \exp(2\pi i (\underline{h} - \underline{k}') \cdot \underline{r}_{i}) dt_{i}$$

Para el caso particular de electrones, el factor de dispersión se define como:

$$f_{e1} = \frac{2 \pi m_0 e}{h^2} \int V(r) \exp(-2\pi i \underline{q} \cdot \underline{r}) d\tau =$$

$$= \frac{2 m_0 e \pi}{h^2} \int \left\{ \int \frac{\underline{g}(r)}{r - r'} d\tau' e^{2\pi i \underline{q} \cdot \underline{r}} \right\} d\tau =$$

$$= \frac{2 \pi m_0 e}{h^2} \int_{r'} g(r') e^{-2\pi i \underline{q} \cdot \underline{r}'} d\tau' \int \frac{e^{-2\pi i \underline{q} \cdot (\underline{r} - \underline{r}')}}{1\underline{r} - \underline{r}'1} d\tau =$$

$$= \frac{2\pi m_0 e}{h^2} \int_{r'} \frac{e(z - f_x)}{\pi + |\underline{q}|^2}$$

siendo fx la amplitud de dispersión de rayos x y Z el número atómico. El factor de dispersión atómica queda como:

$$f(\theta) = \frac{m_{\theta}e}{2h^2} \left(\frac{\lambda}{3en\theta}\right)^2 \left(2-f_x\right)$$

donde debido a la simetria esférica del dispersor, se ha omitido la dependencia en 🍳 .

Para llegar a una expresión para el factor de estructura de la celda unidad, no debemos restringirnos únicamente a la dispersión coherente debida a un átomo aislado, sino que debemos considerar la correspondiente a los átomos que constituyen la celda unidad del cristal. De tal manera que, haciendo uso de la expresión encontrada para el factor de dispersión atómica, obtenemos que:

 $A_{\bullet} = \frac{e^{2\pi kr}}{r} \sum_{i} f_{i}(\theta) e^{-2\pi i \underline{3} \cdot \underline{\Gamma}_{i}} = \frac{e^{2\pi kr}}{r} \sum_{i} F(\theta)$ donde  $F(\theta) = f_{i}(\theta) e^{-2\pi i \underline{3} \cdot \underline{\Gamma}_{i}}$ 

es el factor de estructura de la celda unidad.

Ya que el cristal es una repetición de la celda unidad, consideremos ahora n celdas unitarias, con las cuales se obtiene que, para la amplitud dispersada

$$\varphi_{3} = \sum_{n} F_{n} \exp(2\pi i \underline{g} \cdot \underline{r}_{n})$$

donde  $F_n$  es el factor de estructura de la n-ésima celda y  $r = N_1 Q + N_2 + N_3 C$  es el vector deposición dado en función de los vectors de traslación de la red <u>a</u>, <u>b</u>, <u>c</u>, y los números enteros n, , n<sub>2</sub>, n<sub>3</sub>. De tal manera que si definimos <u>g</u>, el vector de la red recíproca, para una familia de planos (hkl) tenemos:

para la cual ocurrirá un máximo cuando la suma  $N_1 + N_2 k + N_3 k$ sea entero, es decir cuando <u>g.a</u> = h, <u>g.b</u> = k, <u>g.c</u>. = 1. Estas ecuaciones se conocen con el nombre de ECUACIONES DE LAUE. Entonces

 $T_{n \in L} = \sum_{i} f_i(\theta) \exp \left\{ -2\pi i (h u_i + k v_i + l w_i) \right\}$ 

donde ��c, ぴc, ᄡc son las coordenadas fraccionarias del i-ésimo átomo en cada celda unidad.

El factor de estructura no es real, la intensidad de la radiación dispersada encierra F.F\*, donde F\* es al complejo conjugado de F. Nuestro interés radica en los ceros de F porque entonces no hay intensidad en una reflexión g permitida por la red espacial. El factor de estructura se anula en algunas reflexiones permitidas por la red espacial y la falta de reflexiones ayuda a la determinación de la estructura.

Para la red fcc tenemos que F(hkl) = 4f para los indices (hkl) enteros pares o impares; pero si solamente uno de los enteros es par F(hkl) se anula. Para la red bcc se encuentra que F(hkl) = 2f si h+k+l es un entero par y F(hkl) = 0 para h+k+l impar. Y para cristales HCP (hexagonal compacta) las reflexiones no son permitidas para h+2k=3, l impar.

2.3.2 Esfera de Ewald

La condición de difracción es  $\underline{k} = \underline{G} \circ \underline{k}' = \underline{k} + \underline{G}$ , donde  $\underline{G}$  es el vector de la red recíproca. Entonces

por lo tanto

$$2\mathbf{k}\cdot\mathbf{G} + \mathbf{G}^2 = \mathbf{O} \tag{6}$$

Puede demostrarse que (6) es equivalente a la ecuación de Bragg y es conveniente considerarla como la condición de Bragg. En el espacio de Fourier, las reglas de selección <u>k</u> = <u>k</u>' y <u>k'</u>= <u>k</u> + <u>G</u> tienen el significado geométrico indicado en la figura 17.





Los puntos de la parte derecha presentan puntos de la red reciproca del cristal. Si se dibuja una esfera de radio k =  $2\pi/\lambda$  con el centro en el origen de <u>k</u>. Se formará un haz difractado si esta esfera pasa por cualquier otro punto de la red reciproca. En el dibujo la esfera pasa por otro punto distante del extremo de <u>k</u> el vector de la red reciproca <u>G</u>. El haz difractado lo hace en la dirección <u>k'=k+G</u>. Esta construcción se conoce como la Esfera de Ewald.

#### 2.3.3 Desviación de la Condición de Bragg

Si consideramos que el cristal contiene  $M^3$  celdas primitivas entonces la suma sobre mnp lo está a todos los  $M^3$  puntos. En tres dimensiones tendríamos un cristal con  $M_x$ ,  $M_y$ ,  $M_z$  celdas en x,y,z respectivamente. De (Ba) tenemos elevando al cuadrado la intensidad en el punto de difracción:

$$|A|^{2} = |F|^{2} \left[ \frac{Sen^{2}(\pi M_{X} \cdot \underline{G} \cdot \underline{G})}{Sen^{2}(\pi \underline{G} \cdot \underline{G})} \right] \left[ \frac{Sen^{2}(\pi H_{Y} \underline{b} \cdot \underline{G})}{Sen^{2}(\pi \underline{G} \cdot \underline{G})} \right] \left[ \frac{Sen^{2}(\pi H_{Z} \cdot \underline{G})}{Sen^{2}(\pi \underline{G} \cdot \underline{G})} \right]$$
(10)

Si queremos ver cómo se distribuye la intensidad del haz difractado alrededor del punto <u>G</u>, desviémos un poco de él haciendo <u>G'</u> = <u>G</u> + **S**<u>G</u> donde

## $S\underline{G} = S_{\times}\underline{a}^{*} + S_{*}\underline{b}^{*} + S_{*}\underline{c}^{*}$

siendo a\*, b\*, c\* los vectores de la red reciproca, entonces:

 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}' = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{G} + \mathbf{S} \mathbf{G}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{G} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{S} \mathbf{G} = \mathbf{h} + \mathbf{S} \mathbf{x}$ 

análogamente b·G'=k+Sy y c·G'=l+Sz

ya que h,k,l son enteros la ecuación (10), cuando estamos en  $\underline{G}^{\prime}$ , nos dá:

$$|A|^{2} = |F|^{2} \left[ \frac{\operatorname{Sen}^{2} (\pi M_{X} S_{X})}{\operatorname{Sen}^{2} (\pi S_{X})} \right] \left[ \frac{\operatorname{Sen}^{2} (\pi M_{Y} S_{Y})}{\operatorname{Sen}^{2} (\pi S_{X})} \right] \left[ \frac{\operatorname{Sen}^{2} (\pi M_{Y} S_{Y})}{\operatorname{Sen}^{2} (\pi S_{Y})} \right]$$

Si graficamos la componente x de esta ecuación, resulta:



Se tiene un máximo cuando  $\oint = 0$ , con lo cual se cumple la condición de Bragg, y el primer cero se encuentra en  $\oint_{\mathbf{x}} = 1/M_{\mathbf{x}}$ , es decir, la extensión del punto difractado en una dirección es inversamente proporcional al tamaño del cristal en esta dirección.

Esto quiere decir que la esfera de Ewald tocará a puntos de la red recíproca que no cumplen exactamente con la condición de Bragg, es decir que vamos a obtener haces difractados con intensidad apreciable aunque nos desviemos de la condición de Bragg exacta.

Una medida de esta desviación es el vector S<sub>G</sub>, que se define como aquel que va desde el punto <u>G</u> de la red recíproca hasta la esfera de Ewald en la dirección perpendicular a la superficie de la muestra (fig. 18). Puede haber dos casos:



Figura 18

 $S_G > 0$ , el punto nodal <u>G</u> cae dentro de la esfera de Ewald, y  $S_G < 0$ , <u>G</u> está fuera de la esfera. Se observa además que la desviación del ángulo de Bragg es:

 $\Delta \Theta = S_G/G$ 

2.3.4 Formación de un Patron de Difracción

Un patrón de difracción contiene básicamente dos tipos de información:

- El arregio espacial, definido en función de los valores de las distancias que existan entre el punto central y cada uno de los otros puntos de difracción, y los ángulos que se forman entre las líneas que van del centro a cada uno de los puntos.
- Las intensidades, dadas en valores comparativos a la correspondiente al punto central y los otros máximos que ocurren en la difracción.

Debido que para cada punto de la red recíproca hkl habrá un correspondiente punto opuesto ħkī, y ya que el plano de la muestra es normal al haz, el patrón de difracción se mostrará como un sistema de puntos simétricos a través de las líneas vertical y horizontal del centro. Esto puede ser explicado como sigue: si un eje de zona del cristal hace un pequeño ángulo con el haz, cuando es visto a lo largo del eje, los planos se verán sobre las orillas y aparecerán como líneas. Si el haz hace un conveniente ángulo con cualquiera de estos planos, habrá un punto correspondiente en el patrón. Esto ilustra el cambio de forma del patrón con un cambio en la orientación del cristal.

Los patrones mencionados son típicos para un cristal, si el haz electrónico es bastante ancho o la medida del cristal es muy pequeña, tal que la intersección de muchos cristales orientados aleatoriamente (muestra policristalina), el patron de difracción está hecho de un sistema de puntos correspondientes a la orientación de cada cristal, tal que mergen una serie de anillos concéntricos cuyos diámetros corresponden a el espaciado de los planos reflectantes permitidos en el cristal.

#### 2.4 CONTRASTE EN EL MICROSCOPIO ELECTRONICO

El contraste de la imagen puede ser producido por varios mecanismos y puede dependen críticamente de las con-

diciones de operación del microscopio, tal como la orientación de la muestra o del desenfoque de las lentes objetivas.

Nuestro propósito es describir matemáticamente los hechos que ocurren cuando el haz electrónico interactúa con el cristal. En principio, el problema está resuelto si se encuentran las soluciones a la ecuación de Schrödinger. Para el tratamiento matemático de una onda electrónica que pasa a través de un cristal, existen dos aproximaciones: LA TEORIA CINEMATICA y LA TEORIA DINAMICA.

#### 2.4.1 La Teoría Cinamática

La priemra aproximación, llamada teoría cinemática, fué propuesta en 1960 por Hirsch, Howie y Whelan (1), y es importante porque su relativa sencillez pone de manifiesto los hechos relevantes del fenómeno. Su región de validez, sin embargo, es reducida. La principal restricción la impone el hecho de no considerar la interacción entre el haz transmitido y el haz difractado, lo que dá origen a contradicciones que mencionaremos posteriormente.

Las suposiciones envueltas en la teoría cinemática son:

 El haz incidente no está exactamente en la condición de Bragg para reflexiones así que la intensidad difractada es pequeña comparada con la intensidad del haz transmitido. La intensidad incidente es tomada como unidad, así que si I es la intensidad difractada, la intensidad del haz transmitido es I-l.

- La aproximación de "dos haces" es usada, es decir se asume que únicamente un haz difractado (junto con el haz trasmitido) es excitado en el cristal.
- El cristal es muy delgado en la dirección del haz incidente, así que se desprecia la dispersión múltiple y la absorción.

De este modo, en esta teoría tenemos que considerar tres variables: la orientación de la muestra con respecto al haz incidente, el espesor de la muestra, y la desviación de la condición de Bragg.

La intensidad del haz difractado que sale de la superficie inferior del cristal de espesor d es:

$$\left[g = |\varphi_{g}|^{2} = \frac{s_{em}^{2}(\pi S_{g} d)}{S_{g}^{2} S_{g}^{2}}$$
(14)

de la cual se ve que Ig depende de las variables Sg y d. El término Sg nos describe la orientación exacta del cristal con respecto al haz incidente y  $1/4_{g}$ , que tiene dimensiones de L<sup>-1</sup>, se conoce como la DISTANCIA DE EXTINCION. Si mantenemos constante Sg y hacemos variar d vemos que Ig se anula cuando d = n/Sg, con n entero, y es máxima si d = (n + 1/2)/Sg y tiene el valor Imax = 1/(Sg g).





Ahora, Si Sg es variable con d constante, graficamos Ig vs Sg v Ops reculta:

Debido a las oscilaciones de la intensidad de las ondas a través del cristal, cualquier defecto plano inclinado,  $\theta$  en la superficie del cristal dará lugar a franjas de extinción, así que para fronteras de grano, fallas, hoyos y cuñas, las franjas serán observadas como muestra la figura 19. Esta figura es una representación esquemática del origen de las franjas de contraste en imágenes de cristales, mostrando la parte superior una sección transversal presentando las oscilaciones cinemáticas de la intensidad de los haces difractado y transmitido, la periodicidad de la profundidad d' = Sg<sup>1</sup>, AB es una frontera de grano o falla de apilamiento, CD una cuña y E un hoyo. La parte inferior de la figura es una sección normal al haz, representando una imagen de Campo claro en donde se pueden observar los contornos de extinción f.

Si n es el número de franjas, el espesor de la película delgada en la n-franja es d'n. Similarmente d' = (w/tan**w**)M, donde w es el espaciado entre las franjas medida de las fotografía, M es la amplificación y **c(** es el ángulo entre el defecto plano y la normal a la superficie de



Figura 19

la muestra. Por supuesto, las franjas no son observadas cuando el defecto plano es perfectamente normal o paralelo a la superficie del cristal.

Cuando el cristal es de un espesor uniforme, a menudo puede ser doblado como resultado de un manejo descuidado de la muestra, contornos debido al doblamiento son observados. La orientación de estos contornos dependen de la orientación de la muestra y, por lo tanto, no son continuos a través de la frontera de grano. Cuando la muestra se inclina, estos contornos se desplazarán a través del campo de vista. La falla más importante de la teoría cinemática la detectamos cuando se calcula la ecuación (24) cuando estamos exactamente en condición de Bragg (Sg 0) lo cual nos dá la intensidad del haz difractado como Ig =  $(\mathbf{M} d / \boldsymbol{\xi}_g)^2$  que no es válida para d $> \boldsymbol{\xi}_g$  ya que **no**s daría una intensidad mayor que la inicial. Se tienen problemas cuando se utiliza la teoría para predecir la imagen de defectos cristalinos tales como dislocaciones.

2.4.2 La Teoría Dinámica

La teoría dinámica fué propuesta por Howie y Whelan en 1961 y es usada actualmente como la base de todas las investigaciones en microscopía electrónica.

El hacer la aproximación de Born al solucionar la ecuación de Schrödinger, implica no considerar la interacción dinámica entre los haces. La base de la teoría dinámica es tomar en cuenta la interacción entre el haz incidente, la red y los haces difractados entre sí. Considerando la aproximación de dos haces se calculan las intensidades de los haces difractado y transmitido, resultando ser:

$$|\mathcal{A}_{3}|^{2} = \frac{\pi^{2}}{\xi^{2}} \frac{\operatorname{sen}(\pi d \underline{s}_{3})}{(S_{3}\pi)^{2}}$$
$$|\mathcal{A}_{3}| = 1 - |\mathcal{A}_{3}|^{2} \quad \operatorname{con} \quad S_{3} = \sqrt{S_{3}^{2} + \xi^{-2}}$$

Este resultado es igual al cinem ático cuando nos desviamos mucho de la condición de Bragg. Cuando <u>Sg</u> = 0, Sg =  $\xi \bar{g}^1$  con lo que se elimina las complicaciones cinemáticas,

Graficando la variación de la intensidad de los haces en función del espesor tenemos:



De aquí podemos deducir que las intencidades de los haces transmitido y difractado son complementarias y el haz transmitido decae a cero cuando Sg = O en una distancia g/2, por eso g se llama DISTANCIA DE EXTINCION. La distribución de intensidad alrededor de un punto de la red recíproca es:



Vemos que la máxima intensidad corresponde para Sg diferente de cero y la envolvente tiene un semiancho de 2/ g independiente del espesor del cristal.

Las variaciones de la intensidad de los haces directos y difractados en la posición reflectante son mostrados esquemáticamente en la figura 20.



Figura 20

En este caso los cristales de espesor  $(m + 1/2)\xi_{\bullet}$ . tendrá intensidad transmitida igual a cero, mientras que los cristales de espesor m $\xi_{\bullet}$  tendrán intensidad máxima cuando el haz incide en ángulo de Bragg. Así para cristales en forma de cuña, horos, fronteras de grano y fallas a lo largo de un plano inclinado, franjas de igual espesor serán observadas en la imágen de campo claro tal como a lo largo del defecto plano ad (fig. 20) y profundidad ac,c, etc. las franjas se muestran blancas y, aunque los detalles de la teoría cinemática y dinámica son diferentes, el significado cualitativo son similares. Pero la teoría dinámica predice que las franjas se observan siempre iguales, independiente del espesor, cosa que no es así porque cuando el cristal es demasiado grueso, este efecto desaparece.

Esta falla se debe a que en nuestro tratamiento no se ha incluido eventos inelásticos que pudieran dar lugar a una disminución en las intensidades de los haces. 2.4.3 Absorción

H. Yoshioka (8) fué el primero en sugerir que el efecto de absorción se podría introducir sumando un término imaginario al potencial cristalino en forma análoga a lo que sucede a las ondas electromagnéticas cuando viajan en un medio con índice de refracción complejo.

Podemos explicar las observaciones si en la teoría de dos haces introducimos la absorción selectiva de las ondas de Bloch, lo que significa hacer las siguientes transformaciones: Factor de Dispersión A**t**ómica:  $f(\Theta) \longrightarrow f(\Theta) + i f'(\Theta)$ 

Factor de Dispersión A**t**ómica: Potencial Cristalino: Distancia de Extinción:

Esto causa que la onda de Bloch, cuyos máximos estén entre los planos dispersores, pase con mayor facilidad que la otra (fig. 21: la onda 2 se absorbe más que la onda 1).

Planos Reflectores

 $\begin{array}{rcl} U_{3} & \longrightarrow & U_{3} + iU_{3} \\ \xi_{3} & \longrightarrow & \xi_{3} + i\xi_{3} \end{array}$ 

Figura 21

Procediendo en forma análoga para encontrar las amplitudes, llegamos a: ר. -

. . . .

donde

Partiendo de (33) podemos graficar la intensidad del haz, tanto transmitido como difractado en función del espesor del cristal, haciendo **\$**6 =**\$**9, resultando:



Comparándola con la gráfica análoga de la teoría dinámica sin absorción se observa que la intensidad se amortigua, entonces los contornos de extinción son atenuados rápidamente en las regiones gruesas del cristal.

La distribución alrededor de un punto de la red reciproca para un cristal de espesor constante d = 4 g es:



de donde se deduce que las amplitudes de las oscilaciones decrecen cuando se aumenta la absorción, efecto directo de la absorción preferencial de la onda 2. También se deduce que las imágenes de campo claro ya no son simétricas, pero las de campo oscuro si lo son. Esto tiene extraordinaria importancia en la práctica ya que nos asegura que el contraste será altamente dependiente tanto de la magnitud de Sg como su signo. Esto se presenta en imágenes mejor contrastadas cuando Sg≥0.

2.4.4 Efecto de Inclinación de la Muestra

Ya tenemos bien claro que la mayor contribución al contraste de las imágenes de nuestras cristalinas es debido a la difracción. La inclinación de la muestra, por lo tanto, puede producir contraste en una orientación y no en otra.

Un alto contraste se obtiene siempre que hay fuerte difracción de Bragg; por ejemplo, cerca de los contornos de extinción. Estas son las áreas que deben ser vistas con cuidado si se espera encontrar hechos de interés. Así, durante la inclinación, como los contornos de extinción se deslizan a través del campo de vista, efectos de contraste pueden mostrarse en las áreas donde previamente ellos eran invisibles.

١

Inclinando la muestra ayudará a producir una posición de difracción fuerte; entonces todas las áreas que aparecen opacas, inclinandolas unos pocos grados, apareceran transparentes. Esto nos servirá para observar fronteras de grano, ya que si un grano está en condición de Bragg y sus vecinos no, éste aparecerá brillante mientras los demás serán oscuros.

#### CAPITULO III

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

La parte experimental de esta tesis comprendió de dos secciones distintas: la preparación de muestras para la investigación microscópica y la investigación microscópica misma.

#### 3.1 LA PREPARACION DE MUESTRAS

La preparación de muestras del material que se estudió utilizando microscopía electrónica consistió de tres pasos: la preparación del material, el corte y la producción de películas delgadas (thin foils) por pulido electroquímico.

En el área de metalurgía del Instituto de Física se ha diseñado y construido una máquina de termofluencia de esfuerzo **()** constante p**a**ra experimentar con aleaciones metálicas. La figura 22 muestra un dibujo esquemático del aparato; las variables que puede controlar son el esfuerzo, la temperatura y la atmósfera. En este aparato, la probeta es elongada a una carga constante y la vairable dependiente es la deformación plástica la cual se registra como función del tiempo.

Actualmente se está estudiando el crecimiento difusivo de cavidades intergranulares en cobre. Se está trabajando con un método de implantación de cavidades utilizando únicamente termofluencia.



#### Figura 22

Antes de realizar la prueba de termofluencia por medio de la máquina arriba mencionada, la probeta se somete a un tratamiento térmico, el cual sirve para hacer crecer el tamaño de grano y eliminar la mayoría de los defectos cristalinos. Este tratamiento consiste en introducir la probeta en un tubo de cuarzo a 1000°C por espacio de dos horas, operación que se lleva a cabo en un vacío de  $10^{-4}$ atm para evitar la oxidación de la probeta. La prueba de termofluencia se realiza en una atmosfera reductora de 90% N<sub>2</sub> y 10%H<sub>2</sub>, estabilizando la temperatura en 730°C, y se la aplica un esfuerzo de 7**M**Pa hasta, por lo general, producir la fractura de la probeta.

Al final del proceso tenemos una probeta con microgrietas o cavidades. De esta probeta obtendremos la lámina de donde produciremos muestras de 1 cm de largo por 0.5 cm de ancho (fig. 23), siempre conservando la dirección de la línea del esfuerzo, que someteremos al electropulido para terminar con una película delgada.





Al hacer estos cortes de la proebeta, para obtener las muestras, se debe de producir el menor daño posible; por lo tanto no se deben de hacer cortes mecánicos ya que nos introducen dislocaciones en la muestra. El manejo descuidado del material da el mismo resultado. Para evitar ésto, utilizamos una cortadora de hilo AGIEPULS cuyo funcionamiento se basa sobre la tecnología de penetración por electroerosión.

El principio de la penetración por electroerosión es sencillo: la pieza a cortar y el hilo (electrodos) se colocan en posición de trabajo, de tal forma que no se toquen, llenando el espacio entre ellos con un líquido aislante. La pieza y el hilo están conectados, a través de cables, con una fuente de corriente continua de tal manera que al cerrar el circuito se produce una diferencia de potencial

entre ellos haciendo saltar una chispa. En el proceso se produce calor que causa la evaporación de la superficie de la muestra cerca del electrodo. Al sucederse descarga tras descarga se forma un cráter y el resultado es una remoción constante de material en la superficie de la pieza a cortar.

Producimos de este modo muestras con un espesor de aproximadamente 0.5 mm con un mínimo de daño.

Las muestras metálicas son transparentes a los electrones cuando tienen un espesor del orden de pocos angstroms. Para correlacionar las propiedades de las muestras volumétricas con las estructuras que pueden observarse en las películas delgadas es necesario adelgazar las muestras sin modificar o destruir su estructura. Esto puede obtenerse por varios métodos (1) (ataque químico, bombardeo iónico, etc.).

El electropulido causa una perforación sobre la muestra y las áreas cercanas a la perforación son transparentes al haz electrónico.

La dificultad en producir películas delgadas de metales es generar un removimiento uniforme del metal de toda el área de la superficie de la muestra. Para lograr esto, la densidad de corriente en todos los puntos de la muestra debe ser la misma, ya que a densidades de corriente baja, las orillas de la muestra se pulen preferentemente, mientras que a altas densidades de corriente el pulido preferencial ocurre en el centro.

La decisión de cuando se debe parar el electropulido es usualmente obtenida con la experiencia ya que es difficil medir un espesor de 200 a 2000 Å. El criterio usualmente empleado es pararlo cuando aparecenpequeños hoyos, las áreas cercanas a los hoyos son bastante delgadas para ser observadas por transmisión. Si el electropulido continua después de aparecer los hoyos, la distribución de densidad de corriente es modificada, los hoyos se agrandan y las regiones delgadas desaparecen.

Nosotros producimos ataque prefencial en el centro, rociando HNO<sub>3</sub> en solución con alcohol metílico (en proporción de 6 a 4) utilizando una jeringa (método de la jeringa). Así se produce una "cazuela" y el electropulido genera película delgada con una perforación en el centro. El arreglo experimental para electropulir una muestra se presenta en la figura 24.

Para establecer las condiciones de electropulido es necesario obtener la relación corriente-voltaje para el electrolito y el material que serán usados. Existe una relación clásica, que se muestra en la figura 25. La zona plana de la curva dá el rango de voltaje necesario para electropulir. Esta gráfica se obtiene a una cierta temperatura, al variar ésta se modifica la curva en la zona plana. Las condiciones usadas para electropulir las muestras de cobre fueron:



B = Bateria

A = Amperimetro

V = Voltímetro

P = Muestra

C = Cátodo

R = Recipiente para el electrolito

E = Electrolito

T = Baño de temperatura controlada



ELECTROLITO: 90% Acido Fosfórico  $(H_3PO_4)$  y 10%  $H_2O$ CATODO: Grafito VOLTAJE: 2.5 v DENSIDAD DE CORRIENTE: 0.1 amp/cm<sup>2</sup> TEMPERATURA : 20°C

OBSERVACION: Al parar el electropulido se lava con agua pura.



Figura 25

#### 3.2 OBSERVACION CON EL MICROSCOPIO

En la realización de las observaciones se usó un microscopio electrónico JEOL-100CX equipado con un sistema de barrido EM-ASID4D y entrada de goniometro EM-SEG.

El sistema EM-ASID4D permite obtener diferentes tipos de imágenes: electrones secundarios, rransmisión y barrido, retrodispersados y patrones de microdifracción y tunelaje.

El SEG (Entrada de Goniometro-Side Entry Goniometer) está diseñado para permitir que el eje de inclinación sea alineado con un eje en el plano de la muestra, la cual sube o baja de acuerdo con la inclinación. Esto nos asegura que el campo de visión permanesca estacionario cuando la muestra sea inclinada. Para permitir un rango grande de observaciones y medidas varios tipos de portamuestras son disponibles, p.ej: portamuestras de rotación, de inclinación, de elongación, etc. Se usó un geniometro de inclinación el cual nos permite inclinar la muestra <u>+</u> 60° alrededor de un eje que se encuentra en el plano de la muestra.

#### 3.2.1 Calibración del Microscopio Electrónico

Después de que el patrón de difracción es indicado, tiene que ser orientado respecto a la imagen (2). Debido a los campos de las lentes electromagnéticas el haz

viaja a lo largo de una hélice vertical. Por lo tanto, la imágen y su patrón de difracción estan rotados uno con respecto a otro por un cierto ángulo. Este ángulo de rotación es función de la amplificación y hace necesario encontrar la relación entre el ángulo de giro y la amplificación. Para hacer ésto, usamos pequeños cristales de MgO los cuales miden aproximadamente  $10^{-3}$  m<sup>3</sup> y cúbicos: sus superficies son paralelas a los planos 001 (3). Se tomaron el patrón de difracción y su imagen sobrepuestas en una placa y se midió el ángulo entre ellos. Se repitió el procedimiento para varios valores de la amplificación y se graficaron los resultados (fig. 26).

Para encontrar la dirección del esfuerzo de la muestra de termofluencia, utilizamos el sistema de barrido del microscopio. La dirección del esfuerzo es conocida hasta antes de meter la muestra al microscopio. La muestra se coloca de manera que la línea del esfuerzo sea paralela a la dirección de movimiento del portamuestras. Como el sistema de barrido no rota la muestra, podemos tomar una foto topográfica de la imagen y registrar la dirección del esfuerzo, tomando fotos en transmisión a baja amplificación, es posible determinar esta dirección en la muestra. De esta forma conocemos la dirección del esfuerzo entodo momento.

3.2.2 El Contraste en el Microscopio

El procedimiento de la condición de dos haces fué



Figura 26

usada para estudiar los rasgos de contraste ya que es necesario asegurar que mientras un grano estaba en condición de dos haces los granos vecinos no difractan. Esto se realizó por observación alternada de área selecta y patrones de di-

fracción de ambos lados de la frontera. En esta condición, una frontera de grano fué efectivamente una frontera entre un cristal difractor y algún material el cual no tiene otra acción que extinguir ondas electrónicas.

Las franjas de espesor fueron observadas corriendo a lo largo del plano de la frontera, las cuales se van debilitando gradualmente hacia la parte más gruesa y terminando en la parte de la cuña donde la onda de Bloch es absorbida.

3.2.3 Determinación de la Orientación

La orientación de un grano puede ser encontrado a partir de un patrón de área selecta (SADIFF). Este modo de operar el microscopio es el siguiente: seleccionar cualquier porción de la imagen de la pantalla por medio de una apertura insertada en el plano de la imagen intermedia y pasar al modo difracción. El patrón de difracción resultante corresponde al área seleccionada.

Por lo tanto, la desorientación a través de la frontera de grano puede ser determinada fotografiando un patrón de difracción de cada grano mientras la muestra permanece fija en una orientación. De estos datos calculamos la pareja ángulo/(eje de rotación).

3.2.3a Indización de los Patrones de Difracción

Para indizar los patrones de difracción procedemos de la siguiente manera. Sabemos que el cobre es f.c.c. y

que tiene un parámetro de red a=3.6153 Å. Por lo tanto, las reflexiones permitidas son: h,k,l todas pares o todas nones. Las primeras trece reflexiones se dan en la tabla II, donde se ha calculado d(Å) a partir de d(Å) =  $a(Å)[h^2+k^2+l^2]^{\frac{1}{2}}$ 

Del patrón de difracción, se miden las distancias que separan al punto central (haz transmitido) de los puntos no colineales y por medio de la constante de cámara ( $\lambda$ L) se convierten en distancias interplanares. Para esto se usa la fórmula: d(Å) =  $\lambda$ L/R, donde R es la distancia medida del patrón y L es la longitud de cámara, que en nuestro caso L = 70.55 <u>+</u> 0.33 cm. y  $\lambda$  la longitud de onda, su valor es 0.037 Å, por lo que  $\lambda$ L = 2.61 Åcm.

A partir de la tabla II y del valor calculado de d(A) es posible asignar tentativamente indices de Miller a cada punto. Una forma de checar que los indices han sido correctamente asignados es medir los ángulos entre puntos y compararlos con los obtenidos mediante la relación:

# $\cos \theta = \frac{h_{1}h_{2} + k_{1}k_{2} + l_{1}l_{2}}{L(h_{1}^{2} + k_{1}^{2} + l_{1}^{2})(h_{2}^{2} + k_{2}^{2} + l_{2}^{2})]}$

Todos los demás puntos que parecen en el patrón se pueden etiquetar sumando vectorialmente los ya indicados.

Para conocer el eje de zona se efectúa el producto vectorial entre dos puntos del patrón, ya que la dirección perpendicular al plano de la red recíproca es casi paralelo a la dirección del haz, por lo tanto, encontramos la orientación del grano con respecto a la dirección del haz y
T	A	₿	L	Α	I	I	

Reflexión	h <sup>2</sup> +k <sup>2</sup> +1 <sup>2</sup>	(h <sup>2</sup> +k <sup>2</sup> +1 <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	d(Å)
111	3	1.732	2.087
200	4	2.000	1.808
200	8	2.828	1.278
311	11	3.317	1.090
222	12	3.464	1.044
400	16	4.000	0.904
313	19	4.359	0.829
420	20	4.472	0.808
422	24	4.899	0.738
333	27	5.196	0.695
440	32	5.657	0.639
442	36	6.000	0.603
444	48	6,928	0.522
$s = -\delta_{i} \sin q^{i}$			

el plano del grano ya que el eje de zona es perpendicular al plano que tiene los mismos índices de Miller.

Esta orientación es sólamente aproximada dentro de un rango de ± 5° ya que si el grano estuviese exactamente en el plano cálculado, se obtendría un patrón de difracción simétrico alrededor de las líneas horizontal y vertical dibujadas a partir del centro (2). 3.2.3b Cálculo de las Parejas Angulo/(Eje de Rotación)

El cálculo de las parejas ángulo/(eje de rotación) de cada frontera de grano comprende la construcción de la matriz de transformación que nos lleva de un cristal al otro (4). A partir de ésta se obtiene el ángulo y el eje de rotación. Entonces tenemos que encontrar:

a) La matriz del cristal al patrón de difracción.

b) La matriz del microscopio al patrón de difracción.

c) La matriz del cristal al microscopio

d) La matriz de un cristal al otro.

a) La matriz del cristal al patrón de difracción.

Ya que el patrón de difracción obtenido en el microscopio no es más que la proyección de un plano

de **l**a red reciproca, entonces si determinamos a qué familia de planos cristalinso pertenece cada punto aparecido en el patrón de difracción se puede determinar la orientación del cristal con respecto al haz de electrones; es decir, se puede saber cual es la dirección cristalográfica paralela a la dirección del haz de electrones. Entonces, la matriz que va del patrón del patrón de difracción al cristal es:

$$A_{\perp} = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_1 & h_2 & h_3 \\ h_1 & h_2 & h_3 \\ h_1 & h_2 & h_3 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz que va del cristal al patrón de difracción es:  $A_1^{-1}$ . Cálcularemos  $A_1^{-1}$ : Tenemos que

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad con \qquad a_{2i} = ki \qquad i = 1, 2, 3 \\ a_{3i} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad a_{3i} = ki \qquad i = 1, 2, 3 \\ a_{3i} = ki \qquad a_{3i} = a_{3i} = ki \qquad a_{3i} = a_{3i} = a_{3i} \qquad a_{3i} = a_{3i} = a_{3i} \qquad a_{3i} \qquad a_{3i} = a_{3i} \qquad a_{3i} \qquad a_{3i} = a_{3i} \qquad a_$$

b) La matriz que va del patrón de difracción al microscopio.



Figura 27

De la figura 27 obtenemos  $X_1 = l(h,k,l_1)|cose, X_2 = l(h_2k_2l_2)|cose_2 \quad X_3 = 0$   $Y_1 = l(h,k,l_1)|sene, Y_2 = l(h_2k_2l_2)|sene_2 \quad Y_3 = 0$  $Z_1 = 0 \quad Z_2 = 0 \quad Z_3 = l(h_3k_3l_3)|$ 

Entonces

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1); P_2 = (x_2, y_2, z_2); P_3 = (x_3, y_3, z_3).$$

Por lo tanto, la matriz que va del patrón de difracción al microscopio es:

$$B_1 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & 0 \\ y_1 & y_2 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 \end{pmatrix}$$

c) La matriz del cristal al microscopio. Ya que:  $A_1^{-1}$ : matriz que va del cristal al patrón de difracción  $B_1$ : matriz que va del patrón de difracción al microscopio entonces, la matriz que va del cristal al microscopio es:  $B_1 A_1^{-1}$ 

d) La matriz que va de un cristal al otro. Realizando el mismo procedimeinto para el patrón de difracción del otro cristal, pero obteniendo la matriz que va del microscopio al cristal, obtenemos:

Por lo tanto, la matriz que va de un cristal al otro es:  $R = A_2 B_2^{-1} B_3 A_1^{-1}$ 

Ya que tenemos a la matriz que va de un cristal al otro, R, hay que calcular su eigenvector con eigenvalor uno, el cual nos dará el eje de rotación, es decir:

por lo que tendremos el sistema de ecuaciones:

 $(a_{11}-1) \times_1 + a_{12} \times_2 + a_{13} \times_3 = 0$   $a_{21} \times_1 + (a_{22}-1) \times_2 + a_{23} \times_3 = 0$  $a_{31} \times_1 + a_{32} \times_{2+} (a_{33}-1) \times_3 = 0$ 

 $A_{2}B_{2}^{-1}$ 

Sea  $N_1 = [(a_{11} - 1), a_{12}, a_{13}]$   $N_2 = [\dot{a}_{21}, (a_{22} - 1), a_{23}]$   $N_3 = [a_{31}, a_{32}, (a_{33} - 1)]$  $U_1 = (x_1, x_2, x_3)$ 

entonces el sistema (#) equivale a:

 $V_t \cdot N_1 = 0$ ;  $V_t \cdot N_2 = 0$ ;  $V_t \cdot N_3 = 0$ Si escogemos una pareja de n's, p. ej.  $N_1 \leq N_3$ ,  $\leq si$   $N_2 \times N_3 = U_t$ por lo tanto  $V_t$ es el eje de zona, pero si  $N_2 \times N_3 = 0$ escojamos  $N_1$ . Entonces tendremos que  $V_t = (X_1, X_2, X_3)$ es el eje de rotación.

Además:

$$C R = Q_{11} + Q_{22} + Q_{13} = 1 + 2 \cos \theta.$$
  
$$C = arc \cos \left\{ \frac{Q_{11} + Q_{12} + Q_{13} - 1}{2} \right\}$$

con lo que hemos obtenido la pareja ANGULO/(EJE DE ROTACION) de la frontera.

Como son varias fronteras, se diseño u programa para la computadora el cual nos dá los valores del eje de rotación y el ángulo. (Ver apéndice I).

### CAPITULO IV

#### RESULTADOS, DISCUSION Y CONCLUSIONES

En este capítulo presentaremos los resultados obtenidos y realizaremos el análisis y discusión de ellos. Para este propósito dividiremos esta sección en dos partes: una sección descriptiva de las fronteras de grano estudiadas y una sección analítica de tales fronteras.

Utilizaremos el término "muestra" para llamar al conjunto de fronteras que forman las regiones del policristal estudiado.

Un total de 34 fronteras de gran fueron estudiadas en la realización de esta tesis.

#### 4.1 CARACTERISTICAS GENERALES

MUESTRA 1.

Está compuesta de una frontera cuya relación de orientación es 115° alrededor de **(**011**)**. No es frontera de coincidencia, pero es recta y forma esquina (fig. 28). Una parte de la frontera es perpendicular a la línea de tensión y otra parte paralela. Se observa que los hoyos están cerca de la frontera.

Observando la parte de la frontera perpendicular a la línea de tensión a alta amplificación (fig. 29) notamos que ésta es altamente rugosa, existen hoyos cerca a la frontera (posiblemente cavidades por el contraste que presentan, lo cual discutiremos en la siguiente sección). Se observa también pequeñas protuberancias en A. Al llevar la frontera a una condición donde se observan contornos de espesor, las líneas se doblan alrededor de los hoyos como esquivandolos (fig. 30). En la figura 31 se observa por la gran cantidad de rugosidad y protuberencias en la región altamente deformada N, el "nacimiento" de un hoyo.

En la parte de la frontera que es paralela a la línea de tensión se observan hoyos en regiones cerca de la frontera (fig. 32) en H, es menos rugosa y se tienen dislocaciones en la frontera (D) observandose campos de alta deformación elástica (C).

De lo anterior podemos concluir lo siguiente: la frontera no es de coincidencia, sin embargo existen planos donde su energía es mínima, lo que explica que la frontera sea recta. Los hoyos se presentan a un lado de ella. Estos hoyos se producen por cavitación y se deben a un proceso de difusión durante el desarrollo de la prueba de termofluencia. La frontera presenta dislocaciones indicando que tiene estructura periódica que las mentiene ahí. La forma rugosa de la frontera nos revela la existencia de migración segmentada (en regiones localizadas) la cual es inducida por la distribución inhomogenea del esfuerzo resuelto en el plano de la frontera.

MUESTRA 2.

Es un pu**nt**o triple (fig. 33) cuyos granos tienen las siguientes relaciones de orientación.

a) Grano 1 y grano 2: 77.1°/(011), es la coincidencia

b) Grano 2 y grano 3: 58°/<121>, no coincidencia.

d) Grano 3 y grano 1: 63°/**<**100**>,** es de coincidencia.

Veamos las fronteras en su aspecto geométrico: a) La densidad de dislocaciones cristalinas es alta. Presen-

tan dislocaciones de frontera de grano. No tiene hoyos.

- b) Presentan rugosidad pero no hoyos. La densidad de dislocaciones cristalinas es mayor en el cristal G2. Se notan pequeñas protuberancias.
- c) La densidad de dislocaciones cristalinas es mayor en el cristal G1, no presenta hoyos y muestra pequeñas protuberencias.

Todas las fronteras se presentan rectas. La frontera de coincidencia presentan dislocaciones lo que implica una estructura periódica estable. La frontera de no coincidencia presenta alta rugosidad lo cual indica migración segmentada a nivel microscopico.

La falta de dislocaciones cristalinas en el grano 3 parece deberse a fenómenos de recuperación durante el proceso de termofluencia.

MUESTRA 3.

Es un punto triple cuyos granos no guardan relación de orientación de coincidencia (fig. 34). Las relaciones entre ellos son:

- a) Grano 1 y grano 2: 46°/**<**112**>**.
- b) Grano 2 y grano 3: 116°/**<**012**>**.
- c) Grano 3 y grano 1: 75**%**011>.

cuyas características física son:

- a) La frontera es altamente rugosa (fig. 35) presentando alta densidad de dislocaciones. En la parte cercano al punto triple se forma un rectángulo R (fig. 34 y 35). Esta frontera es casi paralela a la línea de tensión.
- b) Se observa mobilidad de la frontera de grano en forma segmentada por la protuberancia en M y no presenta dislocaciones. Esta frontera es casi perpendicular a la línea de tensión. No hay hoyos (figs. 34, 35, 36, 37 y 38).
- c) Se tiene mobilidad de la frontera de grano en igual forma qu en el caso anterior sólo que el "radio de curvatura" es mayor. No presenta dislocaciones y es lisa (figs. 38 y 39) de sus protuberancias. N.

Deducimos de lo anterior que:

- a) La frontera tiene estructura periódica ya que las dislocaciones no se disuelven. Con lo que respecta al rectángulo R, parece ser que hay un plano en donde la energía es mínima o una zona de alta deformación y lo que observamos es el apilamiento de dislocaciones.
- b) Tenemos migración segmentada, que como se dijo anteriormente, produce fronteras-con protuberancias como ésta.
  c) Mismas consideraciones del inciso (b).

MUESTRA 4.

Es una frontera cuyos granos tienen una relación de orientación de 51°/<011>. Es de coincidencia (fig.40).

La muestra presenta dislocaciones cirstalinas y en la frontera. Se nota movilidad segmentada. Note que dentro de la protuberancia C (fig. 40) se encuentra una dislocación cristalina. La frontera se muestra altamente rugosa.

Se presenta un hoyo cerca de la frontera (fig.41) el cual, por el contraste que presenta, parece ser un tunel (esto lo discutiremos en la siguiente sección).

MUESTRA 5.

Es un grano que se encuentra dentro de otro grano. La frontera presenta una relación de orientación de 18º/<012> que no es de coincidencia (fig. 42).

Las partes de la frontera que son perpendiculares a la línea de tensión presentan alta densidad de dislocaciones y son muy rugosas. No presentan hoyos. El cristal que encierra la frontera no presenta dislocaciones cristalinas (figs. 43 y 44). En la parte paralela a la línea de tensión se observan dislocaciones de frontera de grano y hoyos que tienen el mismo contraste que los que llamamos túneles; hay un hoyo en la frontera pero los demás están cerca de ella (fig. 44).

MUESTRA 6.

Es un punto triple cuyas relaciones de orientación entre los granos que lo forman es: (Figs. 45 y 46)

- a) Grano 1 y grano 2: 22°/<111>. No es de coincidencia.
- b) Grano 2 y grano 3:  $24^{\circ}/(120)$ . No es de coincidencia.
- c) Grano 3 y grano 1: 37.5°/⟨110⟩. Si es de coincidencia En las fotografías se observa:
- a) Tiene dislocaciones cristalinas, aunque la densidad en el cristal 1 es menor que la del cristal 2. La frontera es recta y lisa ya que no se notan dislocaciones de frontera de grano.
- b) La frontera tiene una alta densidad de dislocaciones y es más recta que la anterior. El ancho de la proyección de la frontera parece no variar, es estable.
- c) La frontera tiene dislocaciones y es rugosa.

En el punto triple se tienen hoyos de electropulido H (la diferencia entre un hoyo de electropulido y uno de cavitación, tunel, se daŕa en la siguiente sección). Concluimos que:

Las fronteras que tienen dislocaciones están fuertemente estructuradas. La frontera (b) está en un plano de energía mínima porque es muy recta. La frontera (c) que es de coincidencia también tiene estructura.

#### MUESTRA 7

Es una frontera de grano cuyos cristales guardan una relación de coincidencia:  $56^{\circ}/(001)$  (fig. 47).

La frontera presenta alta densidad de dislocaciones por lo que la estructura de la frontera es periódica. Es además muy rugosa y presenta un hoyo en la zona marcada con H.

MUESTRA 8

Es una frontera de grano cuya relación de orientación es 16°/ $\langle$ Oll $\rangle$ , que no es de coincidencia (fig. 48).

La frontera es perpendicular a la línea de tensión y no muestra ningún tipo de dislocaciones pero si protuberancias en P y M.

MUESTRA 9.

La frontera de grano no es de coincidencia ya que su relación de orientación es 77°/(011) (figs. 49 y 50). Tiene dislocaciones de frontera de grano que indican que esta frontera tiene estructura periódica. Se tienen protuberancias en M y P.

MUESTRA 10.

Es un punto triple cuyas fronteras que lo constituyen tienen las relaciones de orientación: a) Grano 1 y grano 2: 81°/(Oll); no és de coincidencia. b) Grano 2 y grano 3: 5:4°/(Oll); no es de coincidencia. c) Grano 3 y grano 1: 107°/(110>; si es de coincidencia. Observamos que (fig. 51):

a) Presenta migración segmentada en M y P.

b) Es una frontera de bajo ángulo, presenta una alta densidad de dislocaciones en la frontera de grano y es muy recta.

MUESTRA 11.

Es una frontera en la cual los cristales presentan una relación de orientación de 74°/≰101≯. No es de coincidencia. Presenta protuberancias muy grandes. (fig. 52). MUESTRA 12.

Esta frontera está formada por dos cristales que tienen una relación relativa de orientación de 66°/(111) la cual no es relación de coincidencia (fig. 53).

Se observan hoyos en H que están cerca de la frontera de grano la cual, aparte de ser recta, es muy rugosa (alta densidad de dislocaciones). Tiene protuberancias en P. La presencia de dislocaciones indican que la frontera tiene estructura periódica.

## MUESTRA 13.

Es un punto triple (fig. 54) cuyos granos tienen las siguientes relaciones de orientación:

a) Grano 1 y grano 2: 88.5°/<101>; es de coincidencia.
b) Grano 2 y grano 3: 6.7°/<101>; no es de coincidencia
c) Grano 3 y grano 1: 93°/<101>; es de coincidencia.

Se observa que los tres cristales tienen una alta densidad de dislocaciones cristalinas las cuales, en las fronteras (a) y (b), interactúan con la frontera exactamente a la orilla de las partes donde hay migración segmentada (letras M y N).

# MUESTRA 14.

Está formada por dos fronteras diferentes con un grano en común (fig. 55), sus relaciones de orientación son: a) Grano 1 y grano 2: 48°/<011>; es de coincidencia. b) Grano 2 y grano 3: 50°/<011>; es de coincidencia.

Esta frontera parece ser un twin, pero  $\Sigma$  = 11. Se observa que el grano 2 tiene fronteras muy rectas y con

alta densidad de dislocaciones en la frontera de grano. Las fronteras son rugosas. Hay un hoyo H en la mitad de la fro<u>n</u> tera.

Concluimos que la frontera muestra ser una zona con migración segmentada a nivel microscópico y que tiene estructura periódica.

MUESTRA 15.

La relación de orientación de la frontera es 92°/【122】 que es una relación de coincidencia (fig. 56).

En la foto se observa que la frontera es bastante rugosa lo cual indica la presencia de dislocaciones. MUESTRA 16.

Al igual que la muestra 14, son fronteras con un grano en común (fig. 57). Sus relaciones de orientación son:

a} Grano 1 y grano 2: 90°/<011>, es de coincidencia.

b) grano 2 y grano 3: 180°/**<**011**>**, no es de coincidencia.

Las fronteras muestran alta densidad de dislocaciones y parece ser que el grano 3 y 1 tienen la misma orientación.

MUESTRA 17.

Es un punto triple cuyos granos tienen las siguientes relaciones de orientación: (fig. 58). a) Grano 1 y grano 2: 55°/【100】; es de coincidencia. b) Grano 2 y grano 3: 121°/【012】; no es de coincidencia. c) Grano 3 y grano 1: 61°/【001】; es de coincidencia. La frontera (c) presenta un hoyo en H cercano a la frontera. Las fracturas (a) y (b) están migrando ya que presentanpequeñas protuberancias.

Hacemos un resumen de las principales características presentadas por las diecisiete muestras en la tabla III. Se ha utilizado las siguientes abreviaciones:

M = Muestra número:

F = Frontera de grano número:

 $\theta$ / hkl = Relación de orientación.  $\theta$  = ángulo y

{hkl> el eje de rotación.

C = Coincidencia

 $\Sigma$  = Razón de área de coincidencia

D = Dislocaciones en la frontera de grano.

H = Hoyos

M.S. = Migración segmentada.

P.P. = Pequeñas protuberancias.

G.P. = Grandes protuberancias.

R = Rugosidad

-----





Figura 31. Muestra 1 (130,000x).



Figura 32. Muestra 1 (160,000x).



# Figura 33. Muestra 2 (50,000x).







Figura 35. Muestra 3. (66,000x).



Figura 36. Muestra 3 (66,000x)



Figura 37. Auestra 3 (50,000x).



Figura 38. Muestra 3 (33,000x).



Figura 39. Muestra 3 (100,000x).



Figura 40. Muestra 4 (33,000x).



Figura 41. Muestra 4 (130.000x).

•



Figura 43. Muestra 5 (26,000x).



Figura 44. Muestre 5 (33,000x).



Figura 45. Muestra 6 (75,000x)



Figura 46. Muestra 6 (30,000x).



Figura 47. Muestra 7 (50,000x).





Figura 49. Muestra 9 (100,000x).



Figura 51. Muestra 10 (100,000x).



Figura 52. Muestra 11 (10,000x).



Figura 53. Muestra 12 (50,000×).



Figura 54. Muestra 13 (13,000x).



Figura 55. Muestra 14 (14,000x)



g2

řigura 57. Muestra 16 (13,000x).



Figura 58. Muestra 17 (50,000x).

د منه منه، معنه المنه ومنظفة ومنطقة ومنظومة في م<u>رد منه ومنها المراجعة المراجعة ومنها المراجعة المراجعة المراجع</u>

TABLA III

							······································
М	F	0/ hkl	С		D	H	OBSERVACIONES
1	1	115°/ <b>(</b> 011)	NO		SI	CERCA	R y MS
	2	111° <u>∕</u> ≮011≯	SI	3	SI	NO	R y MS
2	3	77°/ <b>(1</b> 71 <b>)</b>	NO		SI	NO	R y MS
	4	63°/ <b>(</b> 100 <b>)</b>	SI	17a	SI	NO	P y MS
	5	46°/ <b>⟨</b> 112≯	NO		SI	NO	R
3	6	116°/ <b>(</b> 012 <b>)</b>	NO		NO	NO	M.S. Recta
	7	75°/ <b>(</b> 011 <b>)</b>	NO		NO	NO	M.S. Recta
4	8	51°/ <b>(</b> 011 <b>)</b>	SI	11	SI	Cerca	R y MS
5	-						
	9	18°/ (012)	NO .		S I	Cerca	R y Recta
	10	22°/ (111)	NO		NO	NO	Recta
6	11	24°/(120)	NO		S I	NO	Recta
	12	3/°/ (110)	SI	9	SI.	NO	R
/	13	55°/(001)	SI	5	SI.	EnF,	R
8	14	16°/ <b>(</b> 011 <b>)</b>	NO		NO	NO	R y Recta
9	15	77°/(011)	NO		SL	NO	Py MS
	16	81°/ <b>(</b> 010 <b>)</b>	NO		NO	NO	
10	17	5°/ <b>(</b> 001)	NO		SI	NO	Bajo ángulo
	18	107°/ <b>(</b> 110)	SI	3	NO	NO	Recta y R
11	19	74°/(101)	NO		NO	NO	M.S.
12	20	66°/ <b>(</b> 111 <b>)</b>	NO		SI	Cerca	R y Recta
	21	88°/<101>	SI	17Ь	SI	NO	M.S.
13	22	7°/ <b>(</b> 101 <b>)</b>	NO		NO, -	NO	M.S.
	23	93°/ <b>(</b> 101 <b>)</b>	SI	17b	SI	NO	
14	24	48°/ <b>〈</b> 011 <b>〉</b>	SI	11	SI	EnF	R y Recta
	25	50°/ <b>(</b> 011 <b>)</b>	SI	11	SI	NO	R y Recta
15	26	92° <b>4 (</b> 122 <b>&gt;</b>	SI	9	SI	NO	R y Recta
	27	92°/ <b>(</b> 122 <b>)</b>	SI	9	SI	NO	R y Recta
	28	90°/ <b>〈</b> 011 <b>〉</b>	SI	17b	SI	NO	R y Recta
16	29	178°/ <b>(</b> 011)	NO	ki, ki ji Produkti ingenerati Produkti ingenerati	- S I -	NO	R y Recta
	30	92°/ <b>〈</b> 011〉	SI	17b	SI	NO	R y Recta
	31	55°/ <b>(</b> 011 <b>)</b>	SI	11 -	S I	NO	
17	32	121°/ <b>&lt;</b> 012 <b>&gt;</b>	NO		NO	NO	M.S.
	33	61°/ <b>(</b> 001 <b>)</b>	SI	17a	SI	Cerca	RyP.
					计内容 化分子的	والأرابة مرود فرعانة كالراك وحروه	e Meller e de la contra de la con

4.2 DISCUSION

Podemos resumir los resultados de la sección anterior en el siguiente cuadro:

FRONTERAS	D B S E R V A C I O N E S
RUGOSAS	5
COINCIDENCIA	AS PROTUBERANCIAS
DISLOCA	VCIONES
	HOYOS
DISLOCACIONES	RUGOSAS
	PEQUENAS PROTUBERANCIAS
NU CUINCIDENCIA	NO RUGOSAS (LISAS)
NO DISLOCACIONES	PROTUVERANCIAS GRANDES
	("RADIO DE CURVATURA "GRAN-
	DE Y LISAS)

El término de migración segmentada es usada para describir la migración de la frontera de grano que toma lugar en regiones localizadas de la frontera produciendo protuberancias en ésta. El término rugosidad se usa para referirse a desviaciones microscopicas de la línea recta que presenta la frontera de grano y está asociado a la presencia de dislocaciones de frontera.

Un modelo dinámico de la frontera de grano que explica los resultados obtenidos-fué propuesto por el Dr. David Romeu en su tesis doctoral (1 y 2). Este modelo está basado en el movimiento de dislocaciones en la frontera de grano, en la facilidad con la cual las dislocaciones cristalinas pueden entrar a la frontera y en la interacción entre dislocaciones y dislocaciones con obstáculos presentes en ella.

Una dislocación cristalina se mueve dentro de la red cuando aplicamos un esfuerzo o por activación térmica (ascenso o descenso). En un material policristalino, cuando la dislocación llega a encontrarse con una frontera de grano es frenada ya que del otro lado de la frontera la orientación cristalina es distinta y experimenta una fuerza de resulsión. Si continuamos aplicando el esfuerzo, la microscopía electrónica de transmisión ha mostrado que, las dislocaciones entran a la frontera.

Al entrar en la frontera, la dislocación cristalina puede disociarse en un número de dislocaciones parciales con vectores de Burgers en general no cristalinos.

Si la frontera de grano carece de estructura periódica la dislocación se disociará en un gran número de parciales con vectores de desplazamiento muy pequeños que no pueden ser resueltos. En este caso se dice que la dislocación se disuelve en la frontera.

En caso contrario, si la frontera tiene estructura en alguna medida, la dislocación no se disocia o lo hace con vectores de desplazamiento grandes.

En general, una dislocación en la frontera tendrá su vector de Burgers no paralelo al plano de la misma, y

por lo tanto habrá una componente no cero paralela al plano frontera y otro componente perpendicular. Al moverse las dislocaciones en la frontera como proeucto del esfuerzo aplicado, la componente paralela producirá el deslizamiento relativo de los granos que componen la frontera (esto se muestra en la fig. 59 en D) y la componente normal producirá migración de la misma (fig. 38 en M). Se sigue de aquí que la cantidad de migración es proporcional a la cantidad de deslizamiento.

Al principio de la prueba de termofluencia, la entrada de dislocaciones cristalinas a la frontera. la disociación de estas en parciales y el movimiento en la frontera es relativamente fácil. Al ir avanzando la prueba, las interacciones entre dislocaciones de frontera crean obstáculos que hacen que las dislocaciones se apilen en contra de ellas. Esto impide el movimiento y disociación de más dislocaciones en la frontera. La entrada de dislocaciones cristalinas se inhibe por el esfuerzo que generan las dislocaciones (fig. 32) y en consecuencia, la migración y deslizamiento son cada vez menores hasta llegar a detenerse del todo.

El proceso sólo continua cuando la frontera se deshace de los obstáculos mediante migración. Cuando esto sucede, la frontera migra violentamente en la zona del obstáculo bajo el efecto del esfuerzo producido por las dislocaciones cristalinas y de frontera apiladas en ésta.

Cuando el obstáculo ha sido removido, las dislocaciones apiladas pueden pasar entonces libremente produciendo migración y deslizamiento dando lugar a la rugosidad observada en las fronteras que tienen dislocaciones.

Como el vector de Burgers de las dislocaciones de frontera es, en general, no paralelo al plano de la misma, su movimiento es no conservativo, de tal suerte que en el proceso se generan vacancias. Si la razón de generación de vacancias no es demasiado rápido, el cristal las disuelve manteniendo la concentración de éstas en equilibrio a la temperatura de la prueba.

En aquellas fronteras que sean de coincidencia (tabla I) (entre cero y cinco grados de la orientación exacta) la densidad de dislocaciones es grande y, por ende, también lo es, la densidad de obstáculos. Por esta razón, estas fronteras no se deslizan o migran apreciablemente en este tipo de prueba y la generación de vacancias es limitada.

Por otra parte, en aquellas fronteras que sin ser de coincidencia tienen la suficiente estructura para sostener dislocaciones se observa un efecto más dramático que conduce a la formación de cavidades. En este caso, la distribución de obstáculos es menos densa y más errática que en el caso de fronteras de coincidencia. En estas condiciones, si un obstáculo se encuentra relativamente aislado, cuando este se remueve por el proceso indicado anteriormente, la cantidad de dislocaciones que fluyen por esta zona
es grande pues no existe obstáculo próximo que impida su movimiento. Como el coeficiente de difusión en la frontera de grano es mayor que en el cristal, se generan vacancias a una velocidad mayor de la que el cristal se deshace de ellas y acaban coalesciendo formando una cavidad en el grano opuesto al que migra. Esto da lugar a cavidades en los granos adyacentes a la frontera en las zonas que muestrasn protuberancias.

La figura 60 muestra "el nacimiento" de un hoyo en V y en la figura 61 tenemos un hoyo en H cerca de la frontera y el "nacimiento" de otro en V.

Finalmente tenemos el caso de aquellas fronteras que no presentan dislocaciones. En estas fronteras las dislocaciones cristalinas penetran con facilidad a la frontera y se disocian totalmente en ellas generando migración y deslizamiento. La figura 54 muestra este hecho: en ella puede verse que las fronteras G1, G2 y G3 se han desplazado hacia el interior del grano G2 precisamente en las regiones adyacentes a zonas cristalinas con alta densidad de dislocaciones.

En las figuras 62 y 63 se observan fronteras de grano de experimentos donde las muestras fueron sometidas a tensión pero tomadas con diferentes técnicas, y en diferentes metales, indicando la repetitividad del fenómeno.

Es necesario demostrar que los hoyos observados adyacentes a las fronteras de grano tienen su origen en el proceso de cavitación antes descrito y no son debidos a un

proceso de erosión local durante el tratamiento de electropulido.

Es posible diferenciar entre un hoyo que es producido durante el electropulido y uno proveniente de una cavidad a partir del contraste que presentan.

Los hoyos de cavitación se presentan como "tuneles" que nos comunican la superficie superior con la superficie inferior. El "tunel" se produjo porque ya existía una "burbuja" en el interior del cristal, de modo que al encontrarla el electropulido retiró la parte superior e inferior de ella presentando el contraste de la figura 64a al observarla en el microscopio. Este contraste se observó en los hoyos cercanos a las fronteras de grano (fig. 65).

Un hoyo producido por electropulido terminará con una forma de cuña a las orillas, presentando el contraste de la figura 64b. Este contraste se observó en el microscopio (fig. 66) lo que nos permitió diferenciarlos de un hoyo de cavitación.



Figura 59. Micrografía tomada con el S.E.M. Bicristal de Al después de 20% de deformación por termofluencia. Cortesía de David Romeu (1 y 2). (2,000x).



Figura 60. Micrografía tomada con el S.E.M. BICTISTAL de AL des-pués de 5% de deformación por termofluencia. Corte-sia de David Romeu (1 y 2). (2.000x).

Micrografia tomada con el Figura 61. Micrografia tomada S.E.M. Bicristal de Al descon el S.E.M. Bicris tal de Al después de 15% de deformación por termofluencia. Cortesia de David Romeu (1 y 2). (2,000x). liie u



Figura 63. Micrografía tomada con el S.E.M. Bicrista) de Al después de deformarlo 20% por termofluencia. Cortesía de David Romeu (1,000x). (1 y 2).



Figura 64. (a) hoyo de cavitación, (b) hoyo de electropulido. H = hoyo, f = franjas de espesor.



Figura 65. Hoyo producido por cavitación



Figura 66. Hoyo producido por electropulido.



## 4.3 CONCLUSION

Se estudiaron 34 fronteras de grano, 16 de las cuales resultaron ser de coincidencia (41%). Las fronteras de coincidencia presentan dislocaciones en la frontera de grano lo cual muestra que tienen estructura periódica, no presentan hoyos en/o cerca de la frontera de grano.

Todas las fronteras de coincidencia son rugosas y presentan protuberancias, lo que indican que estaban migrando en forma segmentada durante el proceso de termofluencia.

Las fronteras que presentan hoyos son también rugosas y presentan protuberancias. Sin embargo no son de coincidencia.

Las fronteras de grano de no coincidencia pueden o no presentar dislocaciones de frontera de grano. Las que no tienen dislocaciones de frontera se caracterizan por presentar grandes protuberancias indicando una alta velocidad de migración en zonas localizadas.

Finalmente, en este trabajo se demuestra que el fenómeno de cavitación puede deberse a un fenómeno intrinsicamente diferente al reconocido hasta ahora. De acuerdo al modelo sugerido, las cavidades observadas en la frontera de grano pueden aparecer como una burbuja, no en la frontera de grano sino más bien en una zona adyacente a ésta, en uno de los cristales componentes.

La escasa resolución del microscopio óptico generalmente usado en observación de cavidades puede ser la causa de que hasta ahora este mecanismo no haya sido detectado. Claramente mayor investigación se requiere en este punto.

Apendice: Programa utilizado para cálcular 9/(hkl).

··· ••••••••••				
		SERVICON CODINO CODA	acias).	Next Construction of the Construction of the
- 2 A A A A	11. S	TYDREE REDGET FLUCTARES		
110		DOUBLE FREE ISTON 25-	53,111	ABC-ONTAR-BLANDAREARCHICSON
2.06		[9] REDSTOR ATCLESSENCE	1.0.	01(3-5)-pa(2-2)
		DENERSION MAT(3+3)+R(.	3+325	R((3)35) m(3, 2) m2(3-3)
600		91NEN2108 01(1+3)+02(	5,37,	113(1,3),11(1,3)
510		DIMENSION T(1+3)		
200		DO 10 1-1-3		
860		READ(1+/)(A1(1+J)+J=1	,3>	
900	10	CONTINUE		
1000		DQ 11 1-1-3		승규는 승규는 것을 가지 않는 것을 많이 많이 많이 있다.
1100		READ(1+/)(A2(1+J)+J=	1,3)	
1200	11	CONTINUE	<del>-</del>	
1300		BO 12 In1+3		가슴을 알려 있다. 그는 것이 있는 것이 없다. 이 가지 않는 것이 있는 것이 없는 것이 있는 것이 없는 것이 없 것이 없는 것이 없 않이 없이 없다. 것이 없는 것이 것이 없는 것이 않이 없는 것이 않이
1400		READ(1+/)(B1(1+J)+J=	1.31	an an tha an an tha an an tha an an tha an
1500	12	CONTINUE		
1500		DO 13 I=1,3		
1700		READ(1,/)(B2(1,J),J=	1,3>	이상 물건물을 가지 않는 것을 많이 많이 많다.
.PAGE				김 회사 방법 관련 동안 수 있는 것이 같아. 그는 것이 같아.
1360	13	CONTINUE		
1900		DD 20 I=1.3		
2000		DO 20'J=1,3		그는 것은 것은 것이 가지 않는 것은 것은 것이 같이 많이 많이 많이 했다.
2100		MAT(I,J)≈A1(I,J)		
2200	20	CONTINUE		
2300		CALL INVER (HAT)	14 A.	
2400		DO 21 I=1,3		
2500		DO 21 J=1,3		
2300		A1(1,J)=HAT(1,J)		그는 것이 많은 것이 같이 있는 것이 같이 가지 않을 것이었다. 동안
2700	21	CONTINUE		
2800		DO 22 1=1,3		
2900		DO 22 J=1,3		
3000		MAT(I,J)=B2(I,J)		
3100	22	CONTINUE		
3200		CALL INVER(MAT)		
3300		DO 23 I=1,3		
3400		DG 23 J=1+3		
3200		92(1+J)=HAT(1+J)		
3400	23	CONTINUE	-	
3700		DU 40 I=1,3		
.FAGE .				
3800		DO 40 J=1,3		
3500		M1(I,J)=B1(I,J)		
4000		H2(I,J)=A1(I,J)		
4100	40	CONTINUE		
4200		CALL MULT(M1,M2,R1)		
4300	21	DO 42 I=1,3		
4400		DO 42 J=1,3		
4500		R(I,J)=R1(I,J)		
4600		M1(I;J)=A2(I;J)		
4700		M2((I+J)=B2(I+J)		
4900	42	CONTINUE		
4900		CALL HULT(H1,H2,R1)		
5000		BO 45 I=1+3		
5100		DO 45 J=1,3		
5200		H1(I,J)~R1(I,J)		
5300		H2(1+J)=R(1+J)		energy of the second
5400	45	CONTINUE		
5500		CALL NULTERI+M2+R1)		rrogramador: Victor Castaño
5690		DD 46 1=1+3		na an a
5700		DO 46 J=1+3	- 	

.

						n a far generation and de la series. Anna an anna an
PAGL.					m i sin di tim	
5800		R(I,J)=R1(I,J)	1	•		
5900	4ć	CONTINUE		이 가지 않는 것이 같아?		
5000		N1(1,1)=R(1,1)-1				
6100		N1(1,2)=R(1,2)				
6200		N1(1+3) = R(1+3)	• -			na chine e an channa an chuir
6300		N2(1,1)=R(2,1)				
6400		N2(1)2)=R(2)2/ 1				
8500		$N_{2(1+3)} = N_{2(1-1)}$	•			enan napar ngérapang
6600		N3(1)-7)-P(7-7)		·		a sha ka sa
6700		N3(1, 1)-R(3, 2)-1				a a construction de la construction de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción
6800	100	11T(1-1)=N1(1-7)#8	12(1+3)-1	11(1+3)#N2(	1,2)	
2000	100	UT(1.7)=Ni(1.3) xh	2(1+1)-1	41(1+1)#N2(	1,3)	
7100		UT(1,3)=N1(1,1)*N	12(1,2)-1	1(1,2)*N2(	1,1)	subtracting search and the
7000	100	WRITE (A-200)				المراجع المراج المراجع المراجع
7900	200	FORMAT( OX, "EL E.	JE DE ROT	FACION ES :	+F3.2,F3.	2,F3.2)
7910		WRITE(6+/)VT(1+1)	+VT (1+2)	),VT(1,3)		
7911		F=F+1				
7912		IF(F.E0.3)60 TO 8	36			
7913		IF(F.E0.2) GU TO	34			
.PAGE.					and the second sec	
7914		DO 5 I=1,3				
7915		T(1,I)=N2(1,I)				
7916		N2(1,I)=N3(1,I)				
7917	5	CONTINUE		1. j. e 1. 2.		
7918		60 10 100				
7920	34	DU = 6 = 1 + 3				
7921		N1(1+1)=1(1+1)				
7922						
7923	6	CUNTINUE				
7724	07	TETA~P(1-1)+P(2-2)	+8(3.3)	-1		
8010	00	TETA: TETA/2		- <b>-</b>		
8010		TETASARCOSCIETA	>			a second we have
5021		TETASTETA/3.1415	9268#180			
E100		WRITE(6,300)				an da compositore de la compositore de
8200	300	FORMAT(10X, "EL A	NGULO DE	ROTACION,	EN GRADOS	ES :")
8210		WRITE(6,/)TETA				
8200		STOP				
8400		END				
8500		SUBROUTINE INVER	(MAT)			
		and the second secon				
				•		
		a series produced a	an de grade de la com		and the second second	and a David the second

		217	
Paral.			
1010		BOURLE PRECESSION 854+5	
1500		DIRENSION mat (5/3) (6(3,3)	
1200		DET-001(1,1)*(001(2,2))(0.1(3,2))(0.51(2-3-))(67-5)	
3:00		DETHIER TO F(1+2)*CHALCALSENTE 1- 2 MARTER - 2+32 BA	10 - 113
3900		DET=DE1140T(1+3)>5801(2+1)-301(3+1)-801(2+2+9)	1843-872
1000		A(1+1)=HAT(2+2)*HAT(3+2)-PAT(2+3)*HAT(5+2)	
1100		AC1+2)+BAT (1+3) #HAT (3+2)+ HAT (1+2+\$hAT (3+3)	
7200		A(1+3)=HAT(1+2) HAT(2+3) -HAT(2+2) HAT(1+3)	
1300		A(2+1)=HAT(2+3)#nat(3+1) (A)T(2+1)*HAT(3+3)	
7400		A(2,2)=HAT(1,1)*HAT(3,3)-HAT(1,3)*HAT(3,1)	•
1500		A(2,3)=HAT(1,3) +HAT(2,1) -HAT(1,1)#HA1(2,3)	
7600		A(3+1)=HAT(2+1)THAT(3+2)-HAT(2+2)THAT(3+1)	
1700		A(3,2)=HAT(1,2)+HAT(3,1)-HAT(1,1)+HAT(3,2)	
7300		A(3,3)=HAT(1,1)*HAT(2,2)-HAT(1,2)*HAT(2,1)	
7700		DO 33 1=1-3	
10000		DD 33 J=1+3	
10100		HAT(I,J)=A(I,J)/DET	an an saidh an
10200	33	CONTINUE	
10300		RETURN	na la talangi di sa
10400		END	
.PAGE.			
10500		SUBROUTINE HULT (M1+N2+R1)	
10510		DOUBLE FRECISION M1. H2.R	
10600		DIMENSION M1 (3,3), M2 (3,3), R1 (3,3)	an an an an Anna an An Anna an Anna an
19700		DO 10 I=1+3	
10800		DO 10 J=1+3	
10700		R1(1,J)=H1(1,1)#H2(1,J)+H1(1,2)#H2(2,J)	
10910		R1(I,J)=R1(I,J)+M1(I,3)*M2(3,J)	
11300	10	CONTINUE	
11400		RETURN	•
11500		ENU	
T heleneneraturat.	-		
And Section	فلانتخذ		
***********	ినించ	<b>4</b>	

EL EJE DE ROTACION ES : -2.159277170842560402395640-12. 1.40280766472465460586147, 1.4028076 EL EJE DE RUTACION ES : -2.159277170842560402395660-12; -1.40280766471956066511552; -1.40289" SL EJE DE ROTACION ES : -5.26343236119562342904960-12, -2.389780661202977487633620-12. 2.389 EL ANGULO DE ROTACION, EN GRADOS, ES : 115.0561/5754, ETT IN THE ... 1.1.5 M.Y.Y 100 dista-200 -1. - 1. - 1. - 1. 300 1.,1.,1.

400 -1.,1.,0 500 -1 ... 1 ... 1 . 600 1,1,1 700 -1. .5 - - 1.11+0 0.03 .59,-1.32.0 200 0,0,1.41 1000 1.31,-,81,0 1100 1-24/1.53,0 1200 610,1.41

Ł

## REFERENCIAS

CAPITULO I

1. M. Brillouin, Ann. Chem. Phys. 13, 77 (1898). 2. G. Quincke, Proc. Roy, Soc. A76, 431 (1905). 3. W. Rosenhain and D. Ewen, J. Inst. Metal 10, 125 (1913). 4. N. F. Mott, Proc. Roy. Soc. 60, 391 (1948). 5. T. S. Ke, J. Appl. Phys. 20, 274 (1949). 6. R. C. Gifkins, Mater, Sci. Engng. 2, 181 (1967). 7. W. L. Bragg, Proc. Roy. Soc. 52, 54 (1940). 8. J. M. Burgers, Proc. Roy. Soc. 52, 52 (1940). 9. W. T. Read and W. Schockley, Phys. Rev. 78, 275 (1950). 10. J. C. M. Li, J. Appl. Phys. <u>32</u>, 525 (1961). 11. J. H. Van der Merwe, Proc. Phys. Soc. <u>A63</u>, 616 (1950). 12. C. G. Dunn, Annual AIME Meeting, S. Francisco, Febr. 10, 1959. 13. S. Ranganathan, Acta Cryst. 21, 197 (1966). 14. W. Bollmann, Phil. Mag. <u>16</u>, 363 (1967); <u>16</u>, 383 (1967). 15. F. C. Frank, Conf. Plastic Deformation of Cryst Solids, mellon Inst., Pittsburgh 1950 (p. 150). 16. D. G. Brandon, B. Ralph, S. Ranganathan, and M. S. Wald, Acta Metall. 12, 813 (1964). 17. M. L. Kronberg and F.H. Wilson, Trans. AIME 185, 501 (1949).18. D. G. Brandon, Acta Metall. 14, 1479 (1966). 19. T. Schober and W. Balluffi, Phil. Mag. 21, 109 (1970). 20. W. Bollmann, Phil. Mag. <u>16</u>, 363 (1967).

- 21. J. Levi, Phys. Stat. Sol. <u>31</u>, 193 (1969).
- 22. H. Gleiter, Acta Metall. 17, 565 (1969).
- 23. J. H. Westbrook, Metals Rev. 9, 415 (1964).
- 24. I. A. Grindin and Y. D. Starodubov, Soviet. Phys-Solid State 1, 1642 (1959).
- 25. G. Y. Chin, W. F. Hosford and W. A. Backofen, Trans. MSAIME 240, 437 (1954).
- 26. F. E. Hauser, P. R. Landon and J. E. Dorn, Trans. ASM <u>48</u>, 986 (1956).
- 27. H. Gleiter, G. Bäro, and E. Horbogen, Acta Metall. <u>16</u>, 1053 (1968).
- 28. A. Mascanzoni and G. Buzzichelli, 7e Congrés International de Microscopie Electronique, Grenoble 1970 (p.651).
- 39. Y. Ishida and M. H. Brown, Acta Metall. 15, 857 (1967).
- 30. M. McLean and H. Mykurs, Phil. Mag. 14, 1191 (1966).
- 31. G. A. Chadwick and D. A. Smith, "Grain Boundary Structure and Properties". Materials Science and Technology. Academic Press. 1976.
- 32. G. Friedel, "Lecons de Cristallographie", Paris (1926).
  33. M. Weins, H. Gleiter, B. Chalmers and M. Ashby, Scripta Metall. 3, 60 (1969).

CAPITULO II

 P. B. Hirsch, A. Howie, R. B. Nichelson, D. W. Pashley, and M. J. Whelan "Electron Microscopy of Thin Crystals". Butterworths, London (1965).

- D. K. Bowen and C. R. Hall. "Microscopy of Materials". MacMillan, London (1975).
- J. W. Edington. "Practical Electron Microscopy in Materials Science". McMillan Philips Technical Library Edinhoven (1976).
- M. Cowley. "Difraction Physics". North Holland Publishers Co. (1970).
- 5. Ch. Kittel. "Introduction to Solid State Physics". John Wiley and Sons, New York (1971).
- 6. R. A. Barrios Paredes. "Formación de Imágenes en el Microscopio Electrónico". UNAM, México (1982).
- 7. G. Thomas. "Transmission Electron Microscopy of Metals". Johns Wiley and Sons, Inc. (1964).
- 8. H. Yoshioka, J. Phys. Soc., Japan 12, 628 (1957).
- CAPITULO III
- 1. G. Thomas. "TRasmission Electron Microscopy of Metals". John Wiley and Sons, Inc. (1964).
- Hirsch, A. Howie, R. B. Nichelson, D. W. Pashley, N. J. Shelan. "Electron Nicroscopy of Thin Crystals". Butterworths, London (1965).
- P. Chaudhari and J. W. Mattews, J. Appl. Phys. 42, 3063 (1971).
- M. Marcus y H. Minc. "Elementos de Algebra Lineal".
   Ed. Limusa, México (1978).

 L. D. F. Romeu, Tesis Doctoral: "GBS and its relation internal structure". Dic. 1977.

 L. D. F. Romeu and D. J. Dingley, Inst. of Phys.
 "Electron Microscopy and Analysis". Conference Series <u>52</u>, 193 (1979).